

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-266313
 (43)Date of publication of application : 28.09.2001

(51)Int.Cl. G11B 5/39

(21)Application number : 2000-077309

(71)Applicant : TDK CORP

(22)Date of filing : 17.03.2000

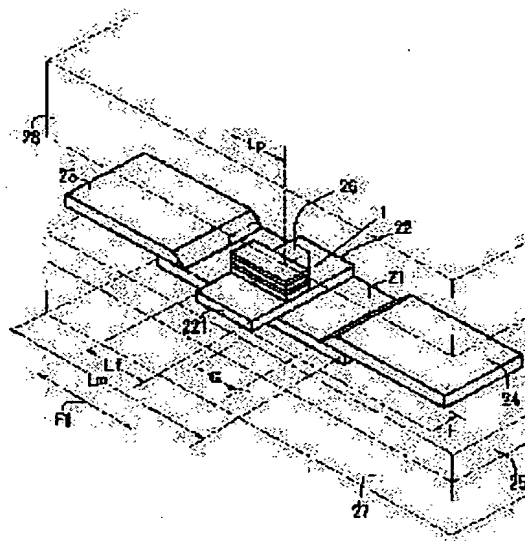
(72)Inventor : SHIMAZAWA KOJI
 KASAHARA HIROAKI
 ARAKI SATORU

(54) TUNNEL MAGNETO-RESISTANCE EFFECT ELEMENT, THIN FILM MAGNETIC HEAD, MAGNETIC HEAD DEVICE AND MAGNETIC DISK DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a TMR element having a highly precise reading track width and applicable to high density recording.

SOLUTION: A ferromagnetic tunnel effect film 1 has a structure where a tunnel barrier layer 11 is held between a free layer 12 and a pinned layer 13. A bias magnetic field inductive layer 21 applies a bias magnetic field to the free layer 12, and has a width seen in the direction F1 of the bias magnetic field larger than that of the ferromagnetic tunnel effect film 1. A flux guide layer 22 is laminated on the bias magnetic field inductive layer 21, and magnetically couple to the free layer 12, one end thereof constituting a flux probing part 221. The flux probing part 221 has a width narrower than that of the bias magnetic field inductive layer 21, and is protruded from the bias magnetic field inductive layer 21.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 16.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3468419

[Date of registration] 05.09.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] It is a tunnel magneto-resistive effect component containing ferromagnetic tunnel effect film, a bias field induction layer, and a flux guide layer. Said ferromagnetic tunnel effect film Said tunnel barrier layer of said pinned layer [free layer and said pinned layer] is pinched including a tunnel barrier layer, a free layer, and a pinned layer. Said bias field induction layer A bias field is impressed to said free layer, and width of face seen in the direction of a bias field is larger than width of face of said ferromagnetic tunnel effect film. Said flux guide layer As the direction of a bias field of said bias field induction layer is intersected, while a laminating is carried out to said bias field induction layer It is the tunnel magneto-resistive effect component which it was magnetically combined with said free layer, and an end constituted the flux probe section, and the width of face of said flux probe section is narrower than width of face of said bias field induction layer, and has been projected from said bias field induction layer.

[Claim 2] It is the tunnel magneto-resistive effect component with which it is the tunnel magneto-resistive effect component indicated by claim 1, the laminating of said ferromagnetic tunnel effect film is carried out to order of said free layer, said tunnel barrier layer, and said pinned layer, the laminating of said flux guide layer is carried out on said bias field induction layer, and said free layer of said ferromagnetic tunnel effect film adjoins a flux guide layer.

[Claim 3] It is the tunnel magneto-resistive effect component said whose flux guide layer it is the tunnel magneto-resistive effect component indicated by claim 2, and is said free layer and this body.

[Claim 4] It is the tunnel magneto-resistive effect component by which it is the tunnel magneto-resistive effect component indicated by claim 1, the laminating of said ferromagnetic tunnel effect film is carried out to order of said pinned layer, said tunnel barrier layer, and said free layer, said bias field induction layer adjoins said free layer, and the laminating of said flux guide layer is carried out on said bias field induction layer.

[Claim 5] It is the tunnel magneto-resistive effect component which it is the tunnel magneto-resistive effect component indicated by any [claim 1 thru/or] of 4 they are, said bias field induction layer has a bias grant means, and said bias grant means contacts crosswise both ends of said bias field induction layer, and has spacing G between crosswise edges of said pinned layer.

[Claim 6] It is the tunnel magneto-resistive effect component which is a tunnel magneto-resistive effect component indicated by claim 5 and by which said bias means is constituted from a layered product of a high coercive force ingredient, an antiferromagnetism ingredient or an antiferromagnetism layer, and ferromagnetic layer much more at least.

[Claim 7] It is the tunnel magneto-resistive effect component to which it is the tunnel magneto-resistive effect component indicated by any [claim 1 thru/or] of 6 they are, and said pinning layer carries out pinning of the magnetization of said pinned layer further including a pinning layer.

[Claim 8] It is the tunnel magneto-resistive effect component which it has an electrode of a pair further, is a tunnel magneto-resistive effect component indicated by any [claim 1 thru/or] of 7 they are, opposite arrangement of the electrode of said pair is carried out so that said ferromagnetic tunnel effect film may be inserted in the direction of a laminating, and is electrically joined to said ferromagnetic tunnel effect film.

[Claim 9] It is the tunnel magnetic resistance element by which opposite arrangement is carried out so that it may be the tunnel magneto-resistive effect component indicated by claim 8 and shielding film of said pair may sandwich an electrode of said pair further including shielding film of a pair.

[Claim 10] It is the thin film magnetic head which it is the thin film magnetic head containing at least one read-out component, and said read-out component becomes with a tunnel magneto-resistive effect component indicated by any of claim 1 **** they are.

[Claim 11] The thin film magnetic head which is the thin film magnetic head indicated by claim 10, and contains at least one write-in component further.

[Claim 12] the thin film magnetic head indicated by claim 11 — it is — said write-in component — an induction type — electromagnetism — a sensing element — it is — said induction type — electromagnetism — the thin film magnetic head from which a sensing element contains the 1st magnetic film, 2nd magnetic film, and gap film, each end is separated with said gap film, and said the 1st magnetic film and said 2nd magnetic film constitute the write-in pole section.

[Claim 13] the thin film magnetic head indicated by claim 11 — it is — said write-in component — an induction type — electromagnetism — a sensing element — it is — said induction type — electromagnetism — the thin film magnetic head with which said 1st magnetic film contains the main pole and an auxiliary magnetic pole including the 1st magnetic film and the 2nd magnetic film in a sensing element, said main pole constitutes the perpendicular

THIS PAGE BLANK (USPTO)

write-in pole section, and said auxiliary magnetic pole has combined magnetically said main pole and said 1st magnetic film.

[Claim 14] It is magnetic-head equipment with which are magnetic-head equipment containing the thin film magnetic head and head means for supporting, and said thin film magnetic head was indicated by any [claim 10 thru/or] of 13 they are, and said head means for supporting come to support said thin film magnetic head.

[Claim 15] It is the magnetic disk drive with which are a magnetic disk drive containing magnetic-head equipment and a magnetic disk, and said magnetic-head equipment was indicated by claim 14, and said magnetic disk comes to carry out magnetic recording and playback between said magnetic-head equipment.

[Claim 16] It is the manufacture approach of ferromagnetic tunnel effect film including a process which is the manufacture approach of ferromagnetic tunnel effect film, and cleans a front face which said tunnel barrier layer of said pinned layer [free layer and said pinned layer] is pinched including a tunnel barrier layer, a free layer, and a pinned layer, and said ferromagnetic tunnel effect film forms before membrane formation of said each class by ion etching.

[Claim 17] It is the manufacture approach of a tunnel magneto-resistive effect component including a process which is the manufacture approach of a tunnel magneto-resistive effect component containing ferromagnetic tunnel effect film, and cleans a front face which said tunnel barrier layer of said pinned layer [free layer and said pinned layer] is pinched including a tunnel barrier layer, a free layer, and a pinned layer, and said ferromagnetic tunnel effect film forms before membrane formation of said each class by ion etching.

[Claim 18] It is the approach of manufacturing the thin film magnetic head containing at least one read-out component. Said read-out component Ferromagnetic tunnel effect film is included. Said ferromagnetic tunnel effect film A manufacture approach of the thin film magnetic head including a process which cleans a front face which said tunnel barrier layer of said pinned layer [free layer and said pinned layer] is pinched, and forms membranes before membrane formation of said each class including a tunnel barrier layer, a free layer, and a pinned layer by ion etching.

[Translation done.]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to a tunnel magneto-resistive effect component (a TMR component is called below), the thin film magnetic head, magnetic-head equipment, and a magnetic disk drive.

[0002]

[Description of the Prior Art] The head of high sensitivity and high power is demanded in connection with the densification of a hard disk (HDD). The TMR component attracts attention as what meets this demand. The TMR component uses the ferromagnetic tunnel effect film which consists of multilayer structure of a ferromagnetic layer / tunnel barrier layer / ferromagnetic layer. The ferromagnetic tunnel effect means the phenomenon in which the tunnel current which flows a tunnel barrier layer changes depending on whenever [angular relation / of magnetization of both ferromagnetic layers], when passing a current between the ferromagnetic layers of the pair whose tunnel barrier layer is pinched. The tunnel barrier layer in this case is a thin insulator layer, and it can pass an electron, saving spin according to the tunnel effect.

[0003] In the TMR component, it is reported that 12% or more of resistance rate-of-change $\Delta R/R$ is shown. about [from which application of magnetic HEDDOHE still began although such a TMR component was expected as a next-generation sensor which replaces the sensor which used the spin bulb film (the Spin Valve film and the following SV film are called)] — it is — as one of the present technical problems — a TMR property — the maximum student or **** — development of new head structure is mentioned. That is, in order for the ferromagnetic tunnel effect film itself to take the geometric structure of passing a current in the thickness direction of a cascade screen, the design of new head structure by which the conventional proposal is not made is required.

[0004] The conventional example which applied the TMR component to magnetic-head structure is indicated by U.S.P.5,729,410, U.S.P.5,898,547, U.S.P.5,898,548, U.S.P.5,901,018, etc. In these official reports, the technical improvement is proposed that it can respond mainly to super-high density record. However, the development demand of the TMR magnetic head to super-high density record will become more advanced, and it waits eagerly for the proposal of the highly efficient TMR magnetic head also compared with the former.

[0005] For example, when using a TMR component as a reading component of the thin film magnetic head, electric short-circuit may occur after the time of polish processing, or polish processing, and the structure of exposing the tunnel barrier layer which consists of a thin insulating layer to a polishing side is not desirable. As a means to avoid such a problem, this invention persons proposed flux probe section type TMR structure previously (Japanese Patent Application No. No. 188472 [11 to]). In this advanced technology, the point of the soft magnetism layer both directly contacted on the ferromagnetic tunnel effect film which arranges the ferromagnetic tunnel effect film in the location into which it withdrew from the polishing side is drawn to the polishing side as the flux probe section. The flux probe section is formed by using a part of free layer of the ferromagnetic tunnel effect film, or newly adding the soft magnetism layer in which size differs from the ferromagnetic tunnel effect film.

[0006] There is another important role in the soft magnetism layer given in order to form the flux probe section. It is a role of a bias field flare part which gives the longitudinal bias field from a hard magnet or the antiferromagnetic substance to the free layer of the ferromagnetic tunnel effect film.

[0007] However, the short-circuit between ferromagnetics will occur on account of the geometric structure which said previously that a hard magnet etc. is contacted to the edge of the ferromagnetic tunnel effect film, and TMR rate of change will be lost by it.

[0008] Moreover, although the short-circuit between ferromagnetics is not generated when a hard magnet etc. is directly contacted for any of the up ferromagnetic of the ferromagnetic tunnel effect film, or a lower ferromagnetic being, a current flows through a hard magnet etc. and TMR rate of change deteriorates.

[0009] As a means to avoid such a problem, this invention persons made T-like configuration the soft magnetism film which constitute the flux probe section, and extended the base of the flux probe section crosswise [truck], it considered as the configuration where width of face be wider than the ferromagnetic tunnel effect film, and the structure which form a hard magnet or an antiferromagnetism layer in a part for the both ends be proposed (Japanese Patent Application No. No. 171869 [11 to]).

[0010] By the way, in connection with the densification of record, it must reduce and the magnetic record pattern recorded on media must also reduce the area of the TMR component carried in the reproducing head in connection with it. For example, in order to make it adapted for the recording density of 40Gbspi, a TMR component must be reduced even to the size of 0.4x0.4 (micrometer²) extent. A detailed mask is formed in formation of such a detailed

THIS PAGE BLANK (USPTO)

pattern with a photolithography technique, and the technique of carrying out pattern NINGU of the metal membrane by ion milling is taken.

[0011] However, with a current photolithography technique, as proposed previously, when the flux probe section and a bias field flare part are constituted from one soft magnetism film, the part of the angle of the flux probe section will be round as a pattern is made detailed. since the regenerative-track width of face of a head is determined by the width of face of the flux probe section when a TMR component is used as a reading component of the thin film magnetic head — such an angle — being round — it becomes the cause of the variation in the width of recording track and is not desirable.

[0012] Although it is necessary to introduce EB exposure technique etc. in order to avoid such a problem, the lateness of a throughput is a problem and equipment itself is a large sum.

[0013] Moreover, when a soft magnetism layer is made into the bigger rectangle than a TMR component instead of the shape of T, it becomes impossible to make the width of recording track smaller than a TMR component, and is not desirable.

[0014]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] The technical problem of this invention is to offer a TMR component applicable to super-high density record, the thin film magnetic head, magnetic-head equipment, and a magnetic disk drive.

[0015] Another technical problem of this invention is offering the TMR component which has the highly precise reading width of recording track, the thin film magnetic head, magnetic-head equipment, and a magnetic disk drive.

[0016]

[Means for Solving the Problem] In order to solve such a technical problem, the TMR component concerning this invention contains the ferromagnetic tunnel effect film, a bias field induction layer, and a flux guide layer.

[0017] As for said ferromagnetic tunnel effect film, said tunnel barrier layer of said pinned layer [free layer and said pinned layer] is pinched including the tunnel barrier layer, the free layer, and the pinned layer.

[0018] Said bias field induction layer impresses a bias field to said free layer, and the width of face seen in the direction of a bias field is larger than the width of face of said ferromagnetic tunnel effect film.

[0019] As said flux guide layer intersects the direction of the bias field of said bias field induction layer, while a laminating is carried out to said bias field induction layer, it was magnetically combined with said free layer, and the end constituted the flux probe section, the width of face of said flux probe section is narrower than the width of face seen in the direction of the bias field of said bias field induction layer, and it is projected from said bias field induction layer.

[0020] The TMR component concerning this invention has the ferromagnetic tunnel effect film which consists of multilayer structure of a free layer / tunnel barrier layer / pinned layer, and when a current is passed between the free layers and pinned layers whose tunnel barrier layer is pinched, the tunnel current which flows a tunnel barrier layer changes depending on whenever [angular relation / of the magnetization between a free layer and a pinned layer] (the TMR effectiveness). Although the direction of magnetization of a pinned layer is immobilization, the direction of magnetization of a free layer changes according to an external magnetic field. Therefore, an external magnetic field is detectable by detecting the current which flows for a TMR component, or its rate of change.

[0021] The TMR component concerning this invention contains a bias field induction layer. A bias field induction layer impresses a bias field to said free layer. Thereby, the Barkhausen noise in a free layer can be removed and the detecting signal of high quality can be obtained. As for the bias field induction layer, the width of face seen by the longitudinal direction has become larger than the width of face of said ferromagnetic tunnel effect film. Therefore, spacing can be separated from the ferromagnetic tunnel effect film to a part for the both ends of the cross direction of a bias field induction layer, and a bias grant means can be formed in it. For this reason, the short-circuit between ferromagnetics by the bias grant means etc. is avoidable.

[0022] Furthermore, the TMR component concerning this invention contains a flux guide layer. A flux guide layer is magnetically combined with a free layer, and an end constitutes the flux probe section. This flux probe section is projected from the bias field induction layer. An external magnetic field is introduced from the flux probe section, passes along a flux guide layer, and is impressed to a free layer. Therefore, in application to the thin film magnetic head etc., the flux probe section is located in a polishing side, and the ferromagnetic tunnel effect film can be arranged in the location into which it withdrew from the polishing side. For this reason, it is avoidable that electric short-circuit occurs in a tunnel barrier layer after the time of polish processing or polish processing.

[0023] The width of face of the flux probe section is narrower than the width of face seen in the direction of the bias field of a bias field induction layer, and since it has projected from the bias field induction layer, when it uses as a reading component of the thin film magnetic head, the regenerative-track width of face of a head can be set as the minute value determined by the width of face of the flux probe section.

[0024] And since the laminating of the flux guide layer is carried out to the bias field induction layer and it is layer with an another bias field induction layer, it can be formed according to membrane formation process that a bias field induction layer is another.

[0025] The flux guide layer intersects the direction of the bias field of a bias field induction layer, and the end constitutes the flux probe section. Therefore, also when a flux guide layer produces a radius of circle in an edge, the radius-of-circle part can be removed and the part by which the width-of-face dimension was stabilized can be used as the flux probe section. For this reason, the TMR component which has the highly precise reading width of recording track can be obtained.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[0026] In a concrete mode, the laminating of the ferromagnetic tunnel effect film is carried out to the order of a free layer and tunnel barrier layer and a pinned layer, or a laminating is carried out to the order of a pinned layer, a tunnel barrier layer, and a free layer.

[0027] When the ferromagnetic tunnel effect film has the structure which carried out the laminating to the order of a free layer and tunnel barrier layer and a pinned layer, the laminating of the flux guide layer can be carried out on a bias field induction layer, and the structure of making the free layer of the TMR film adjoining a flux guide layer can be adopted. In this case, a flux guide layer can be formed in a free layer and this body.

[0028] When the ferromagnetic tunnel effect film has the structure which carried out the laminating to the order of a pinned layer, a tunnel barrier layer, and a free layer, a bias field induction layer can be made to be able to adjoin a free layer, and the structure which carries out the laminating of the flux guide layer on a bias field induction layer can be adopted.

[0029] The bias field induction layer has the bias grant means, and a bias grant means contacts the both ends of the cross direction of a bias field induction layer, and it has a tooth space between the crosswise edges of a pinned layer. According to this structure, the short-circuit between ferromagnetics and the circumference lump of a current are avoidable. A bias means may consist of layered products of a high coercive force ingredient, an antiferromagnetism ingredient or an antiferromagnetism layer, and ferromagnetic layer much more at least. Moreover, the ferromagnetic tunnel effect film contains a pinning layer. This pinning layer carries out pinning of the magnetization of a pinned layer.

[0030] This invention is indicated again also about the electrode structure, the shielding structure over the ferromagnetic tunnel effect film, the thin film magnetic head that read the TMR component and was further used as a component, the magnetic-head equipment using this thin film magnetic head, and the magnetic disk drive for passing a current on the ferromagnetic tunnel effect film. This invention is further indicated also about the manufacture approach of the ferromagnetic tunnel effect film.

[0031]

[Embodiment of the Invention] The perspective view showing one example of the TMR component which drawing 1 requires for this invention, the expanded sectional view of the TMR component which showed drawing 2 to drawing 1, and drawing 3 are the sectional views which met three to 3 line of drawing 2. These drawings are exaggeratingly illustrated so that he can understand the description part of this invention easily. The perimeter of the part shown by hatching is covered with the nonmagnetic insulating layer which becomes with the ceramics etc.

[0032] The illustrated TMR component contains the ferromagnetic tunnel effect film 1, the bias field induction layer 21, and the flux guide layer 22. The ferromagnetic tunnel effect film 1 includes the tunnel barrier layer 11, the free layer 12, and a pinned layer 13. The tunnel barrier layer 11 of a pinned layer [the free layer 12 and] 13 is pinched.

[0033] The free layer 12 acts so that the external magnetic field which is magnetic information fundamentally may be answered and the sense of magnetization may be changed freely. Moreover, pinning of the pinned layer 13 is carried out so that the whole of the magnetization direction may turn to the fixed direction. Therefore, the laminating of the pinning layer 14 for carrying out pinning of the magnetization of a pinned layer 13 is usually carried out to a field opposite to the side which touches the tunnel barrier layer 11 of a pinned layer 13.

[0034] The bias field induction layer 21 impresses a bias field to the free layer 12, and the width of face seen in the direction of the bias field F1 is larger than the width of face of the ferromagnetic tunnel effect film 1. The bias field induction layer 21 has the bias means 23 and 24. The bias field of the free layer 12 is impressed through the bias field induction layer 21 by the bias grant means 23 and 24. The bias means 23 and 24 may consist of layered products of a high coercive force ingredient, an antiferromagnetism ingredient or an antiferromagnetism layer, and ferromagnetic layer much more at least.

[0035] As the direction F1 of the bias field of the bias field induction layer 21 and the flux guide layer 22 cross at right angles mostly, the laminating is carried out to the bias field induction layer 21. It was further combined with the free layer 12 magnetically, and the end constituted the flux probe section 221, the width of face of the flux guide layer 22 is narrower than the width of face of the bias field induction layer 21, and it has projected the flux probe section 221 from the bias field induction layer 21.

[0036] In the illustration example, the laminating of the ferromagnetic tunnel effect film 1 is carried out to the order of the free layer 12, the tunnel barrier layer 11, and a pinned layer 13. The laminating of the flux guide layer 22 is directly carried out on the bias field induction layer 21. The free layer 12 of the ferromagnetic tunnel effect film 1 is contacted and formed on the whole surface of the flux guide layer 22.

[0037] The TMR component concerning this invention has the ferromagnetic tunnel effect film 1 which consists of multilayer structure of the 11/pinned layer 13 of 12/tunnel barrier layers of free layers, and when a current is passed between the free layers 12 and pinned layers 13 whose tunnel barrier layer 11 is pinched, the tunnel current which flows the tunnel barrier layer 11 changes depending on whenever [angular relation / of the magnetization between the free layer 12 and a pinned layer 13]. Although the direction of magnetization of a pinned layer 13 is immobilization, the direction of magnetization of the free layer 12 changes according to an external magnetic field. Therefore, an external magnetic field is detectable by detecting the current which flows for a TMR component, or its rate of change.

[0038] Since a TMR component impresses a bias field to the free layer 12 by the bias field induction layer 21 including the bias field induction layer 21, it can remove the Barkhausen noise in the free layer 12, and can obtain the detecting signal of high quality. Since the width of face seen in the direction F1 of a bias field is larger than the width of face of the ferromagnetic tunnel effect film 1, the bias field induction layer 21 can separate spacing G from

THIS PAGE BLANK (USPTO)

the ferromagnetic tunnel effect film 1 to a part for the both ends of the cross direction of the bias field induction layer 21, and can form the bias grant means 23 and 24 in it. For this reason, the electric short-circuit between the free layer 12-pinned layers 13 by the bias grant means 23 and 24 etc. is avoidable.

[0039] Furthermore, the TMR component concerning this invention contains the flux guide layer 22. The flux guide layer 22 is magnetically combined with the free layer 12, and the end constitutes the flux probe section 221. This flux probe section 221 is projected from the bias field induction layer 21. An external magnetic field is introduced from the flux probe section 221, passes along the flux guide layer 22, and is impressed to the free layer 12.

Therefore, in application to the thin film magnetic head etc., the flux probe section 221 is located in the polishing side PS 1 (refer to drawing 3), and the ferromagnetic tunnel effect film 1 can be arranged in the location into which it withdrew from the polishing side PS 1. For this reason, it is avoidable that electric short-circuit occurs in the tunnel barrier layer 11 after the time of polish processing or polish processing.

[0040] The width of face Lf of the flux probe section 221 is narrower than the width of face Lm of the bias field induction layer 21, and since it is projected from the bias field induction layer 21, when the TMR component concerned is used as a reading component of the thin film magnetic head, it can set the regenerative-track width of face of a head as the minute value determined by the width of face Lf of the flux probe section 221.

[0041] And since the flux guide layer 22 is layer with the another bias field induction layer 21, it can form the flux guide layer 22 according to membrane formation process that the bias field induction layer 21 is another. The flux guide layer 22 intersects the direction F1 of the bias field of the bias field induction layer 21, and the end constitutes the flux probe section 221. Therefore, also when the flux guide layer 22 produces a radius of circle in the edge, the radius-of-circle part can be removed and the interstitial segment by which the width-of-face dimension was stabilized can be used as the flux probe section 221. For this reason, the TMR component which has the highly precise reading width of recording track can be obtained.

[0042] The width of face Lp of the ferromagnetic tunnel effect film 1 is equal to the width of face Lf of the flux probe section 221, or is set up greatly smaller than the width of face Lm of the bias field induction layer 21. Width of face Lf of about 0.5-4 micrometers and the flux probe section 221 is set to about 0.1-2 micrometers for the width of face Lm of the bias field induction layer 21.

[0043] Furthermore, 0.01-0.3 micrometers depth H [0.01-0.2 micrometers] of the flux guide layer 22 is preferably set as 0.01-0.1 micrometers still more preferably. Although the more infinite one near 0 of this H value is good, the danger of an electrostatic discharge arises or the electric short danger of the free layer 12 and pinned layer 13 in a polish process arises as it becomes small. Therefore, a lower limit is good to be referred to as about 0.01 micrometers. On the other hand, if this H value exceeds 0.3 micrometers, an output will decline, or a crosswise bias field will become inadequate and a Barkhausen noise will arise.

[0044] Opposite arrangement of the electrodes 25 and 26 of a pair is carried out at the upper and lower sides of the direction of a laminating of the ferromagnetic tunnel effect film 1. A sense current is supplied to the ferromagnetic tunnel effect film 1 with the electrodes 25 and 26 of this pair. Opposite arrangement of the magnetic-shielding layers 27 and 28 of a pair is carried out so that these may furthermore be covered, respectively.

[0045] As for the bias field induction layer 21, a bias field is impressed crosswise by the bias grant means 23 and 24. The width of face Lm of the bias field induction layer 21 is set up more greatly than the width of face Lp of a pinned layer 13, and the bias field induction layer 21 serves as a gestalt to which only the part with the width of face Lm longer than the die length Lp of a pinned layer 13 equipped the both ends at least with the extension, respectively.

[0046] In order to make it not reduce TMR rate of change substantially, as for spacing G, setting to the predetermined range is desirable. If the numeric value experimentally found out as a desirable mode is mentioned, as for especially the spacing G, it will be desirable to consider as the range 0.02 micrometers or more of 0.3 micrometers or less, and the 0.02 more micrometer or more range of less than 0.15 micrometers 0.02 micrometers or more.

[0047] When the value of spacing G is set to less than 0.02 micrometers, it is in the inclination for TMR rate of change to fall. If this G value becomes large too much and exceeds 0.3 micrometers on the other hand, the inclination which the effective width of recording track spreads and stops agreeing in the future demand to a raise in recording density will arise.

[0048] Moreover, although especially the thickness of the free layer 12 in this invention is not limited, it is good preferably to set [2-5nm / 4-3nm] it as the range of 6-2nm more preferably. If this thickness is set to less than 2nm, it will become difficult on a membrane formation technique to make width of face Lm of the cross direction of the bias field induction layer 21 into sufficient magnitude. Moreover, if this thickness exceeds 50nm, by dispersion in the property of the free layer 12 interior, distribution of electron spin polarizability will arise and un-arranging [that TMR rate of change will decrease as a result] will arise.

[0049] The quality of the material which constitutes the free layer 12 and a pinned layer 13 has a desirable high spin polarization ingredient so that high TMR rate of change may be obtained, for example, Fe, Co, nickel, FeCo, NiFe, CoZrNb, FeCoNi, etc. are used. These may be the layered products more than two-layer. As mentioned above, 2-5nm of thickness of the free layer 12 is preferably set to 6-2nm. If there is an inclination for an output to decline if thickness becomes thick too much and thickness becomes thin too much, magnetic properties will become unstable and un-arranging [that the noise at the time of head actuation increases] will arise. 1-10nm of thickness of a pinned layer 13 is preferably set to 2-5nm. If pinning of the magnetization by the pinning layer 14 will become weaker if thickness becomes thick too much, and thickness becomes thin too much, the inclination for TMR rate of change to decrease will arise.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[0050] Although the pinning layer 14 which carries out pinning of the magnetization of a pinned layer 13 will not be especially limited if the pinning function is achieved, an antiferromagnetism ingredient is usually used. Thickness is usually set to about 60–5nm.

[0051] The tunnel barrier layer 11 consists of Al₂O₃, NiO, GdO, MgO, Ta₂O₅, MoO₂ and TiO₂, and WO₂ grade. Although it is desirable that it is thin as much as possible for the reduction in resistance of a component, it is too thin not much, and leakage current will drop off and the thickness of the tunnel barrier layer 11 is not desirable, if a pinhole is generated. Generally, it may be about 0.5–2nm.

[0052] voice also with desirable also using the free layer 12 as the synthetic ferry magnet (synthetic ferrimagnet) illustrated by the three-layer layered product of for example, a NiFe layer (2nm in thickness) / Ru layer (0.7nm in thickness) / NiFe layer (2.5nm in thickness) in this invention — it is one [like]. In this case, the magnetization direction of an up-and-down NiFe layer and a NiFe layer is hard flow mutually, respectively. Since the thickness of the effectual free layer 12 can be thinly set up when a synthetic ferry magnet is used, magnetic field sensibility improves and there is a merit that an output becomes large. Moreover, such a synthetic ferry magnet is applicable also to a pinned layer 13.

[0053] Moreover, in the gestalt of the above-mentioned operation, although the bias grant means 23 and 24 are arranged at the both-ends bottom of the free layer 12, they may be arranged to the down side, without being limited to this.

[0054] The perspective view showing another example of the TMR component which drawing 4 requires for this invention, the expanded sectional view of the TMR component which showed drawing 5 to drawing 4, and drawing 6 are the sectional views which met six to 6 line of drawing 5. In drawing, the same reference mark is attached about the same component as the component which appeared in drawing 1 –3. In this example, the laminating of the ferromagnetic tunnel effect film 1 is carried out to the order of the free layer 12, the tunnel barrier layer 11, and a pinned layer 13. The flux guide layer 22 is formed in the free layer 12 and this body. Although the flux guide layers 22 are the free layer 12 and this body, the bias field induction layer 21 is another layer, and the laminating of them is carried out on the bias field induction layer 21.

[0055] The perspective view showing another example of the TMR component which drawing 7 requires for this invention, and drawing 8 are the sectional views which met eight to 8 line of drawing 7. In drawing, the same reference mark is attached about the same component as the component which appeared in drawing 1 –3. In this example, the ferromagnetic tunnel effect film 1 has the structure which carried out the laminating to the order of a pinned layer 13, the tunnel barrier layer 11, and the free layer 12. The bias field induction layer 21 adjoins the free layer 12, and the laminating of the flux guide layer 22 is carried out on the bias field induction layer 21. The flux guide layer 22 is another layer in the bias field induction layer 21.

[0056] The perspective view showing another example of the TMR component which drawing 9 requires for this invention, and drawing 10 are the sectional views which met ten to 10 line of drawing 9. In drawing, the same reference mark is attached about the same component as the component which appeared in drawing 1 –3. In this example, the ferromagnetic tunnel effect film 1 has the structure which carried out the laminating to the order of a pinned layer 13, the tunnel barrier layer 11, and the free layer 12. The bias field induction layer 21 is formed in the free layer 12 and this body. The flux guide layer 22 is another layer in the bias field induction layer 21, and the laminating is carried out on the bias field induction layer 21.

[0057] Next, with reference to drawing 11 –23, the production process of the bias field induction layer 21 and the FURAKUSU guide layer 22 is especially explained about the manufacture approach of the TMR component illustrated to drawing 1 –3. Although the various thin film pattern formation techniques in which the photoresist method, ion milling, lift off, the spatter forming-membranes method, etc. are well-known are used on the occasion of manufacture, explanation of the individual detail technique is omitted here.

[0058] First, the bias field induction layer 21 is formed on the electrode layer 25 which carried out the laminating on the shielding layer 27 so that it may illustrate to drawing 11 and 12. The shielding layer 27 and the electrode layer 25 are covered with nonmagnetic insulating layers, such as ceramics.

[0059] The flux guide layer 22 is formed on the bias field induction layer 21 so that it may illustrate to degree drawing 13 and 14. In order to make it adapted for the recording density of 40Gbps as mentioned above, the ferromagnetic tunnel effect film must be reduced even to the size of 0.4x0.4 (micrometer²) extent. The flux guide layer 22 also becomes a detailed pattern corresponding to the size mentioned above. If such a detailed pattern is formed with a photolithography technique, a radius of circle will be produced in the corner of the flux guide layer 22 so that it may illustrate to drawing 13.

[0060] Next, as shown in drawing 15, the ferromagnetic layer 13 used as the ferromagnetic layer 12 used as a free layer, the insulating layer 11 used as a tunnel barrier layer, and a pinned layer is formed on the bias field induction layer 21 and the flux guide layer 22. It is desirable to clean the front face which forms membranes before membrane formation of each class 11–14 by ion etching in membrane formation of these each class 11–14. According to such cleaning, it can avoid that a resist residual contamination layer or an oxidizing zone is formed in the interface of each class, and resistance increase of the ferromagnetic tunnel effect film finally obtained can be prevented.

[0061] Next, as shown in drawing 16, the resist film 100 is formed in the front face of the ferromagnetic layer 13 by the predetermined pattern. The resist film 100 has the pattern extended to the proximal region of the flux guide layer 22 from the field with which the bias field induction layer 21 and the flux guide layer 22 lap.

[0062] And as shown in drawing 17, ion milling etc. removes the part which is not covered with the resist film 100. Drawing 18 and 19 show the pattern after removal. As shown in drawing 18 and 19, the cascade screen of the

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ferromagnetic layer 12, an insulating layer 11, and the ferromagnetic layer 13 is formed on the flux guide layer 22. The pattern of this cascade screen turns into the almost same pattern as the resist film 100.

[0063] Next, after exfoliating according to the means of common knowledge of the resist film 100, as shown in drawing 20, another resist film 110 is formed by the predetermined pattern. The resist film 110 is formed so that it may become the pattern which the point which wore the radius of circle of the both ends of the bias field induction layer 21, and the point which wore the radius of circle of the flux probe film 22 expose. And as shown in drawing 21, the point which wore the radius of circle of the both ends of the bias field induction layer 21 which is not covered with the resist film 110 with means, such as ion milling, and the point which wore the radius of circle of the flux probe film 22 are removed.

[0064] Drawing 22 and 23 show the condition after removing the resist film 110 after the milling mentioned above. The point which wore the radius of circle of both ends is removed, and patterning of the bias field induction layer 21 is carried out so that it may have die length predetermined by the stable width of face, so that it may illustrate. Moreover, the both ends which wore the radius of circle of the flux guide layer 22 are also removed, and it becomes the dimension stabilized by the width of face of the flux guide layer 22 and the ferromagnetic tunnel effect film on it.

[0065] Next, as shown in drawing 24, as a part of front face of the ferromagnetic tunnel effect film 1 is exposed, it forms the resist film 120, and ion milling is performed as shown in drawing 25. In this ion milling, milling of the ferromagnetic layer 13, the tunnel barrier layer 11, and the ferromagnetic layer 12 which constitute the ferromagnetic tunnel effect film 1 is carried out. Thereby, as shown in drawing 26 and 27, the flux guide layer 22 which has the flux probe edge 221 which projects with a predetermined dimension is obtained. The TMR component illustrated to drawing 4 -6 can also be manufactured according to the same process.

[0066] Next, with reference to drawing 28 -35, the manufacture approach of drawing 7 and the TMR component illustrated to 8 is explained. First, after forming the ferromagnetic layer 13 used as the ferromagnetic layer 12 used as a free layer, the insulating layer 11 used as a tunnel barrier layer, and a pinned layer on the electrode layer 25 which carried out the laminating on the shielding layer 27 so that it may illustrate to drawing 28 and 29, the bias field induction layer 21 is formed. The perimeter of the shielding layer 27, the electrode layer 25, the ferromagnetic layer 12, an insulating layer 11, and the ferromagnetic layer 13 is covered with nonmagnetic insulating layers, such as ceramics. As stated above, it is desirable to clean the front face which forms membranes before membrane formation of each class 11-14 by ion etching in membrane formation of each class 11-14 which constitutes the ferromagnetic tunnel effect film 1. According to such cleaning, it can avoid that a resist residual contamination layer or an oxidizing zone is formed in the interface of each class, and resistance increase of the ferromagnetic tunnel effect film finally obtained can be prevented.

[0067] The flux guide layer 22 is formed on the bias field induction layer 21 so that it may illustrate to degree drawing 30 and 31. In order to make it adapted for the recording density of 40Gbspi as mentioned above, the ferromagnetic tunnel effect film must be reduced even to the size of 0.4x0.4 (micrometer²) extent. The flux guide layer 22 also becomes a detailed pattern corresponding to the size mentioned above. If such a detailed pattern is formed with a photolithography technique, a radius of circle will be produced in the corner of the flux guide layer 22 so that it may illustrate to drawing 30.

[0068] Next, as shown in drawing 32, the resist film 130 is formed by the predetermined pattern. The resist film 130 is formed so that it may become the pattern which the point which wore the radius of circle of the both ends of the bias field induction layer 21, and the point which wore the radius of circle of the flux probe film 22 expose. And as shown in drawing 33, means, such as ion milling, remove the both ends of the bias field induction layer 21 which is not covered with the resist film 130, and the point which wore the radius of circle of the flux probe film 22. Thereby, the bias field induction layer 21 by which width of face was stabilized, and the flux guide layer 22 are obtained.

[0069] Drawing 34 -36 show the configuration which removed the resist film 130 and was acquired after the milling mentioned above. The point which wore the radius of circle of both ends is removed, and patterning of the bias field induction layer 21 is carried out so that it may have die length predetermined by the stable width of face, so that it may illustrate. Moreover, the both ends which wore the radius of circle of the flux guide layer 22 are also removed, and it becomes the dimension stabilized by the width of face of the flux guide layer 22 and the ferromagnetic tunnel effect film on it. The flux guide layer 22 which has by this the flux probe edge 221 which projects with a predetermined dimension is obtained. Drawing 9 and the TMR component illustrated to 10 can also be manufactured according to the same process.

[0070] the TMR component which drawing 37 mentioned above — reading — as a component — using — an induction type — electromagnetism — the perspective view of the thin film magnetic head for the record within a field which wrote in the sensing element and was used as a component, and drawing 38 show the expanded sectional view of the thin film magnetic head shown in drawing 37. The thin film magnetic head of illustration has the write-in component 5 which consisted of TMR components which start this invention on a slider 4 and which reads and becomes by the component 6 and the induction type MAG sensing element. An arrow head A1 shows the medium transit direction. In drawing, the dimension is exaggerated partially and differs from a dressed size.

[0071] A slider 4 has rails 41 and 42 in a medium opposed face side, and the front face of a rail is used as ABS 43 and 44. Rails 41 and 42 are not restricted to two. It may become the flat surface which may have 1-3 rails and does not have a rail. Moreover, various geometry may be given to a medium opposed face for a surfacing property improvement etc. Even if it is the slider 4 of which type, application of this invention is possible. Moreover, since a slider 4 is equipped with protective coats, such as DLC which has about 8-10nm thickness, on the surface of a rail,

THIS PAGE BLANK (USPTO)

in such a case, the front face of a protective coat serves as ABS 43 and 44. A slider 4 is the ceramic structure which formed aluminum 2O3 and the inorganic insulator layer 420 of SiO2 grade in the front face of the base 410 which becomes by aluminum2O3-TiC etc.

[0072] Both one side [of rails 41 and 42] or trailing . edge TR side is equipped with the write-in component 5 and the reading component 6. a slider 4 is equipped with the write-in component 5 and the reading component 6 — having — electromagnetism — the edge for conversion is located in ABS 43 and 44 and the location which approached. The ejection electrodes 47 and 48 which were connected to the write-in component 5 and which took out and were connected to electrodes 45 and 46 and the reading component 6 are formed in the slider side face in the trailing . edge TR side, respectively.

[0073] The write-in component 5 has the gap film 54, an insulator layer 55, a protective coat 56, etc. which become with the 1st magnetic film 51 which serves as the 2nd [to the reading component 6] shielding film, the 2nd magnetic film 52, the coil film 53, an alumina, etc. Independently of the 1st magnetic film 51, you may have the 2nd shielding film.

[0074] The end sections (point) 510 and 520 of the 1st magnetic film 51 and the 2nd magnetic film 52 are the pole section which separates the gap film 54 of minute thickness and counters, and write in in the pole section. The 1st and 2nd magnetic films 51 and 52 may be monolayers, and may be double layer membrane structures. Double layer membrane-ization of the 1st and 2nd magnetic films 51 and 52 may be performed for the purpose of for example, a property improvement. Various amelioration and a proposal are made also about the structure of the pole section from viewpoints, such as improvement in narrow-izing of the width of recording track, and record capacity. In this invention, any pole structure proposed until now is employable. The gap film 54 is constituted by inorganic insulator layers, such as non-magnetic metal film or an alumina.

[0075] The 2nd magnetic film 52 inclines and starts to a pole section side at a certain include angle to a field parallel to the field of the gap film 54. Further, the 2nd magnetic film 52 maintains an inner gap between the 1st magnetic film 51, is prolonged behind ABS 43 and 44, and is combined with the 2nd magnetic film 52 in back. Thereby, the thin film magnetic circuit involving the 1st magnetic film 51, 2nd magnetic film 52, and gap film 54 is completed.

[0076] The coil film 53 is inserted between the 1st and 2nd magnetic films 51 and 52, and turns around the surroundings of a back bond part to a curled form. It has flowed through the both ends of the coil film 53 in the ejection electrodes 45 and 46 (refer to [drawing 37](#)). The number of turns and number of layers of the coil film 53 are arbitrary. The coil film 53 is laid under the interior of an insulator layer 55.

[0077] The interior of the inner gap between the 1st and 2nd magnetic films 51 and 52 is filled up with the insulator layer 55. The front face of an insulator layer 55 is equipped with the 2nd magnetic film 52. An insulator layer 55 consists of organic insulation resin film or ceramic film. The example of representation of the ceramic film is 2Oaluminum3 film or SiO2 film. If the ceramic film constitutes an insulator layer 55, since the thermal expansion of an insulator layer 55 will become small as compared with the case where an organic compound insulator is used, a result good for reducing the amount of the maximum protrusions is obtained.

[0078] In the protective coat 56, the protective coat 56 has covered the write-in whole component 5. By this, the write-in whole component 5 will be protected by the protective coat 56. The protective coat 56 consists of inorganic insulating materials of aluminum 2O3 or SiO2 grade.

[0079] The reading component 6 consists of TMR components concerning this invention. This reading component 6 is arranged inside the insulator layer 63 between the 1st shielding film 61 and the 2nd shielding film 63. The insulator layer 63 is constituted by the alumina etc. The reading component 6 is connected to the ejection electrodes 47 and 48 which flow on the 1st shielding film 61 and the 2nd shielding film 62 (refer to [drawing 37](#)).

[0080] [Drawing 39](#) is the expanded sectional view of the thin film magnetic head for vertical recording. In the illustrated thin film magnetic head for vertical recording, the 2nd magnetic film 52 contains the main pole 525 and the auxiliary magnetic pole 526. The main pole 525 constitutes the perpendicular write-in pole section, and the auxiliary magnetic pole 526 combines magnetically the main pole 525 and the 1st magnetic film 51. The 1st magnetic film 51 constitutes the return magnetic path of the magnetic flux produced from the main pole 525. The coil film 53 is wound around the surroundings of the main pole 525 and the auxiliary magnetic pole 526. Since it is substantially the same, explanation is abbreviated to the thin film magnetic head for the record within a field which showed other structures to [drawing 37](#) . Since the description of magnetic recording using the thin film magnetic head for vertical recording magnetizes the magnetic-recording film of a magnetic disk in the direction which becomes perpendicular to a film surface and performs magnetic recording, it is that very high recording density is realizable.

[0081] The front view showing some magnetic-head equipments which [drawing 40](#) requires for this invention, and [drawing 41](#) are the bottom views of the magnetic-head equipment shown in [drawing 40](#) . Magnetic-head equipment contains the thin film magnetic head 8 and the head means for supporting 7. The thin film magnetic head 8 is the thin film magnetic head concerning this invention explained with reference to [drawing 37](#) -39.

[0082] The head means for supporting 7 have structure which attached the flexible body 71 which similarly becomes with a metallic thin plate in the free end in the end of the longitudinal direction of the base material 73 which becomes with a metallic thin plate, and attached the thin film magnetic head 8 in the inferior surface of tongue of this flexible body 71.

[0083] A flexible body 71 has two outside frame parts 75 and 76 which carry out abbreviation parallel with the longitudinal direction axis of a base material 73, and are extended, the transversal frame 74 which connects the outside frame parts 75 and 76 in the edge distant from the base material 73, and the ligula 72 which has been prolonged so that abbreviation parallel may be carried out from the abbreviation center section of the transversal

THIS PAGE BLANK (USPTO)

frame 74 at the outside frame parts 75 and 76, and used the tip as the free end.

[0084] The projection 77 for loads of the shape of a semi-sphere of a ligula 72 which upheaved from the base material 73 in the center section mostly is formed. The load force is told from the free end of a base material 73 by this projection 77 for loads to a ligula 72.

[0085] The thin film magnetic head 8 is attached in the inferior surface of tongue of a ligula 72 with means, such as adhesion. The thin film magnetic head 8 is attached in the ligula 72 so that an airstream appearance side edge side may become in the direction of a transversal frame 74. The head means for supporting 7 applicable to this invention are not restricted to the above-mentioned example.

[0086] Drawing 42 is drawing showing typically the configuration of the magnetic disk drive concerning this invention. The illustrated magnetic disk drive contains magnetic-head equipment 9 and a magnetic disk 10. Magnetic-head equipment 9 is illustrated to drawing 40 and 41. The end of the head means for supporting 7 is supported by the pointing device 11, and magnetic-head equipment 9 is driven. The thin film magnetic head 8 of magnetic-head equipment is supported by the head means for supporting 7, and it is arranged so that it may counter with the magnetic-recording side of a magnetic disk 10.

[0087] If the rotation drive of the magnetic disk 10 is carried out in the direction of an arrow head A1 by the driving gear which is not illustrated, the thin film magnetic head 8 will surface from the field of a magnetic disk 10 by the minute flying height. By the positioning device 11 which carries out the rotation drive of the head means for supporting 7, the thin film magnetic head 8 which the magnetic disk drive illustrated by drawing 42 is a drive method called a rotary . actuator method, and was attached in the point of the head means for supporting 7 is driven in the directions b1 or b2 of a path of a magnetic disk 10, and is positioned in the predetermined truck location on a magnetic disk 10. And magnetic recording by the write-in component 5 and reading actuation by the reading component 6 which has a TMR component are performed on a predetermined track.

[0088] As mentioned above, although the contents of this invention were concretely explained with reference to the desirable example, it is obvious that various deformation modes can be taken based on the fundamental technical thought of this invention and instruction if it is this contractor.

[0089]

[Effect of the Invention] According to this invention, the following effectiveness can be acquired as stated above.

- (a) A TMR component applicable to super-high density record, the thin film magnetic head, magnetic-head equipment, and a magnetic disk drive can be offered.
- (b) The TMR component which has the highly precise reading width of recording track, the thin film magnetic head, magnetic-head equipment, and a magnetic disk drive can be offered.

[Translation done.]

THIS PAGE BLANK (11/15/77)

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

- [Drawing 1] It is the perspective view showing one example of the TMR component concerning this invention.
- [Drawing 2] It is the expanded sectional view of the TMR component shown in drawing 1 .
- [Drawing 3] It is the sectional view which met three to 3 line of drawing 2 .
- [Drawing 4] It is the perspective view showing another example of the TMR component concerning this invention.
- [Drawing 5] It is the expanded sectional view of the TMR component shown in drawing 4 .
- [Drawing 6] It is the sectional view which met six to 6 line of drawing 5 .
- [Drawing 7] It is the perspective view showing another example of the TMR component concerning this invention.
- [Drawing 8] It is the sectional view which met eight to 8 line of drawing 7 .
- [Drawing 9] It is the perspective view showing another example of the TMR component concerning this invention.
- [Drawing 10] It is the sectional view which met ten to 10 line of drawing 9 .
- [Drawing 11] It is drawing showing the process included in the manufacture approach of the TMR component illustrated to drawing 1 -3.
- [Drawing 12] It is the sectional view which met 12 to 12 line of drawing 11 .
- [Drawing 13] They are drawing 11 and drawing showing the process after the process shown in 12.
- [Drawing 14] It is the sectional view which met 14 to 14 line of drawing 13 .
- [Drawing 15] They are drawing 13 and the sectional view showing the process after the process shown in 14.
- [Drawing 16] It is drawing showing the process after the process shown in drawing 15 .
- [Drawing 17] It is the sectional view which met 17 to 17 line of drawing 16 .
- [Drawing 18] They are drawing 16 and drawing showing the process after the process shown in 17.
- [Drawing 19] It is the sectional view which met 19 to 19 line of drawing 18 .
- [Drawing 20] They are drawing 18 and drawing showing the process after the process shown in 19.
- [Drawing 21] It is the sectional view which met 21 to 21 line of drawing 20 .
- [Drawing 22] They are drawing 20 and drawing showing the process after the process shown in 21.
- [Drawing 23] It is the sectional view which met 23 to 23 line of drawing 22 .
- [Drawing 24] They are drawing 22 and drawing showing the process after the process shown in 23.
- [Drawing 25] It is the sectional view which met 25 to 25 line of drawing 24 .
- [Drawing 26] They are drawing 24 and drawing showing the process after the process shown in 25.
- [Drawing 27] It is the sectional view which met 27 to 27 line of drawing 26 .
- [Drawing 28] It is drawing showing the process included in the manufacture approach of drawing 7 and the TMR component illustrated to 8.
- [Drawing 29] It is the sectional view which met 29 to 29 line of drawing 28 .
- [Drawing 30] They are drawing 28 and drawing showing the process after the process of 29.
- [Drawing 31] It is the sectional view which met 31 to 31 line of drawing 30 .
- [Drawing 32] They are drawing 30 and drawing showing the process after the process shown in 31.
- [Drawing 33] It is the sectional view which met 33 to 33 line of drawing 32 .
- [Drawing 34] It is drawing showing drawing 32 and the pattern pass the process of 33.
- [Drawing 35] It is the sectional view which met 35 to 35 line of drawing 34 .
- [Drawing 36] It is the sectional view which met 36 to 36 line of drawing 34 .
- [Drawing 37] the TMR component concerning this invention — reading — as a component — using — an induction type — electromagnetism — perspective view **** of the thin film magnetic head for the record within a field which wrote in the sensing element and was used as a component.
- [Drawing 38] It is the expanded sectional view of the thin film magnetic head shown in drawing 37 .
- [Drawing 39] It is the expanded sectional view of the thin film magnetic head for vertical recording which read the TMR component concerning this invention and was used as a component.
- [Drawing 40] It is the front view showing some magnetic-head equipments concerning this invention.
- [Drawing 41] It is the front view showing some magnetic-head equipments concerning this invention.
- [Drawing 42] It is drawing showing typically the configuration of the magnetic disk drive concerning this invention.
- [Description of Notations]
- 1 Ferromagnetic Tunnel Effect Film
- 11 Tunnel Barrier Layer
- 12 Free Layer

THIS PAGE BLANK (USPTO)

13 Pinned Layer
21 Bias Field Induction Layer
22 Flux Guide Layer
221 Flux Probe Section

[Translation done.]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-266313

(P2001-266313A)

(43) 公開日 平成13年9月28日 (2001.9.28)

(51) Int.Cl.

G 1 1 B 5/39

識別記号

F I

G 1 1 B 5/39

データベース(参考)

5 D 0 3 4

審査請求 有 請求項の数18 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2000-77309(P2000-77309)

(22) 出願日 平成12年3月17日 (2000.3.17)

(71) 出願人 000003067

ティーディーケー株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 島沢 幸司

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケー株式会社内

(72) 発明者 笠原 寛順

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケー株式会社内

(74) 代理人 100081606

弁理士 阿部 美次郎

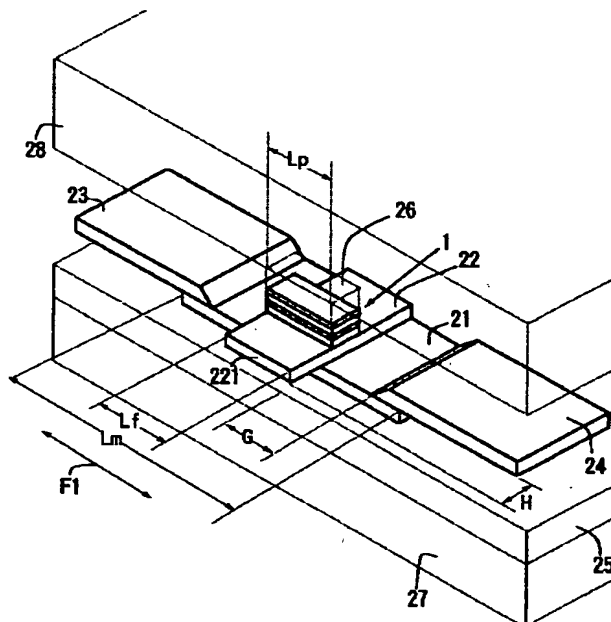
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 トンネル磁気抵抗効果素子、薄膜磁気ヘッド、磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置

(57) 【要約】

【課題】 高精度の読み取りトラック幅を有し超高密度記録に適用できTMR素子を提供する。

【解決手段】 強磁性トンネル効果膜1は、トンネルバリア層11がフリー層12とピンド層13とによって挟まれた構造を有する。バイアス磁界誘導層21は、フリー層12にバイアス磁界を印加するものであって、バイアス磁界の方向F1で見た幅が強磁性トンネル効果膜1の幅よりも大きい。フラックスガイド層22はバイアス磁界誘導層21と積層されるとともに、フリー層12に磁氣的に結合され、一端がフラックスプローブ部221を構成する。フラックスプローブ部221はその幅がバイアス磁界誘導層21の幅よりも狭く、バイアス磁界誘導層21から突出している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 強磁性トンネル効果膜と、バイアス磁界誘導層と、フラックスガイド層とを含むトンネル磁気抵抗効果素子であって、

前記強磁性トンネル効果膜は、トンネルバリア層と、フリー層と、ピン層とを含み、前記トンネルバリア層が前記フリー層と前記ピン層とによって挟まれており、前記バイアス磁界誘導層は、前記フリー層にバイアス磁界を印加するものであって、バイアス磁界の方向で見た幅が前記強磁性トンネル効果膜の幅よりも大きくなっており、

前記フラックスガイド層は、前記バイアス磁界誘導層のバイアス磁界の方向と交差するようにして、前記バイアス磁界誘導層と積層されるとともに、前記フリー層に磁氣的に結合され、一端がフラックスプローブ部を構成し、前記フラックスプローブ部はその幅が前記バイアス磁界誘導層の幅よりも狭く、前記バイアス磁界誘導層から突出しているトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項2】 請求項1に記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、前記強磁性トンネル効果膜は、前記フリー層、前記トンネルバリア層及び前記ピン層の順に積層されており、

前記フラックスガイド層は、前記バイアス磁界誘導層の上に積層されており、

前記強磁性トンネル効果膜の前記フリー層は、フラックスガイド層に隣接するトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項3】 請求項2に記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

前記フラックスガイド層は、前記フリー層と一体であるトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項4】 請求項1に記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

前記強磁性トンネル効果膜は、前記ピン層、前記トンネルバリア層及び前記フリー層の順に積層されており、前記バイアス磁界誘導層は、前記フリー層に隣接しており、

前記フラックスガイド層は、前記バイアス磁界誘導層の上に積層されているトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項5】 請求項1乃至4の何れかに記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

前記バイアス磁界誘導層は、バイアス付与手段を有しており、前記バイアス付与手段は前記バイアス磁界誘導層の幅方向両端部に接触し、かつ、前記ピン層の幅方向端部との間に間隔Gを有するトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項6】 請求項5に記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

前記バイアス手段は、高保磁力材料、反強磁性材料、または反強磁性層と少なくとも一層の強磁性層との積層体から構成されるトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項7】 請求項1乃至6の何れかに記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

更に、ピン止め層を含み、前記ピン止め層は、前記ピン層の磁化をピンニングするトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項8】 請求項1乃至7の何れかに記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

更に、一対の電極を有し、前記一対の電極は、前記強磁性トンネル効果膜を積層方向に挟むように対向配置され、前記強磁性トンネル効果膜に電氣的に接合されているトンネル磁気抵抗効果素子。

【請求項9】 請求項8に記載されたトンネル磁気抵抗効果素子であって、

更に、一対のシールド膜を含み、前記一対のシールド膜は、前記一対の電極を挟むように対向配置されているトンネル磁気抵抗素子。

【請求項10】 少なくとも1つの読み出し素子を含む薄膜磁気ヘッドであって、

前記読み出し素子は、請求項1乃至の何れかに記載されたトンネル磁気抵抗効果素子でなる薄膜磁気ヘッド。

【請求項11】 請求項10に記載された薄膜磁気ヘッドであって、

更に、少なくとも1つの書き込み素子を含む薄膜磁気ヘッド。

【請求項12】 請求項11に記載された薄膜磁気ヘッドであって、

前記書き込み素子は、誘導型電磁変換素子であり、前記誘導型電磁変換素子は、第1の磁性膜、第2の磁性膜及びギャップ膜を含んでおり、

前記第1の磁性膜及び前記第2の磁性膜は、それぞれ的一端が前記ギャップ膜によって隔てられ、書き込みポール部を構成している薄膜磁気ヘッド。

【請求項13】 請求項11に記載された薄膜磁気ヘッドであって、

前記書き込み素子は、誘導型電磁変換素子であり、前記誘導型電磁変換素子は、第1の磁性膜と、第2の磁性膜とを含み、

前記第1の磁性膜は、主磁極と、補助磁極とを含んでおり、

前記主磁極は、垂直書き込みポール部を構成しており、前記補助磁極は、前記主磁極及び前記第1の磁性膜を磁氣的に結合している薄膜磁気ヘッド。

【請求項14】 薄膜磁気ヘッドと、ヘッド支持装置とを含む磁気ヘッド装置であって、

前記薄膜磁気ヘッドは、請求項10乃至13の何れかに記載されたものでなり、

前記ヘッド支持装置は、前記薄膜磁気ヘッドを支持する磁気ヘッド装置。

【請求項15】 磁気ヘッド装置と、磁気ディスクとを含む磁気ディスク装置であって、

前記磁気ヘッド装置は、請求項14に記載されたものでなり、

前記磁気ディスクは、前記磁気ヘッド装置との間で、磁気記録、及び、再生を行う磁気ディスク装置。

【請求項16】 強磁性トンネル効果膜の製造方法であって、

前記強磁性トンネル効果膜は、トンネルバリア層と、フリー層と、ピンド層とを含み、前記トンネルバリア層が前記フリー層と前記ピンド層とによって挟まれており、前記各層の成膜前に、成膜する表面をイオンエッチングによりクリーニングする工程を含む強磁性トンネル効果膜の製造方法。

【請求項17】 強磁性トンネル効果膜を含むトンネル磁気抵抗効果素子の製造方法であって、

前記強磁性トンネル効果膜は、トンネルバリア層と、フリー層と、ピンド層とを含み、前記トンネルバリア層が前記フリー層と前記ピンド層とによって挟まれており、前記各層の成膜前に、成膜する表面をイオンエッチングによりクリーニングする工程を含むトンネル磁気抵抗効果素子の製造方法。

【請求項18】 少なくとも1つの読み出し素子を含む薄膜磁気ヘッドを製造する方法であって、

前記読み出し素子は、強磁性トンネル効果膜を含んでおり、

前記強磁性トンネル効果膜は、トンネルバリア層と、フリー層と、ピンド層とを含み、前記トンネルバリア層が前記フリー層と前記ピンド層とによって挟まれており、前記各層の成膜前に、成膜する表面をイオンエッチングによりクリーニングする工程を含む薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、トンネル磁気抵抗効果素子（以下TMR素子と称する）、薄膜磁気ヘッド、磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置に関する。

【0002】

【従来の技術】ハードディスク（HDD）の高密度化に伴い、高感度、高出力のヘッドが要求されている。TMR素子はこの要求に応えるものとして注目されている。TMR素子は、強磁性層／トンネルバリア層／強磁性層という多層構造からなる強磁性トンネル効果膜を利用している。強磁性トンネル効果とは、トンネルバリア層を挟む一対の強磁性層間に電流を流す場合に、トンネルバリア層を流れるトンネル電流が、両方の強磁性層の磁化の相対角度に依存して変化する現象を言う。この場合のトンネルバリア層は、薄い絶縁膜であって、トンネル効果によりスピンを保存しながら電子が通過できるものである。

【0003】TMR素子においては、12%以上の抵抗変化率 $\Delta R/R$ を示すことが報告されている。このよう

なTMR素子は、スピンバルブ膜（Spin Valve膜、以下SV膜と称する）を用いたセンサに代わる次世代のセンサとして期待されているものの、磁気ヘッドへの応用はまだ始まったばかりであり、当面の課題の一つとしてTMR特性を最大限生かせる新規なヘッド構造の開発が挙げられる。すなわち、強磁性トンネル効果膜そのものが、積層膜の厚さ方向に電流を流す幾何学的構造をとるために、従来提案されていない新しいヘッド構造の設計が要求される。

【0004】TMR素子を磁気ヘッド構造に応用した従来例は、U.S.P. 5,729,410、U.S.P. 5,898,547、U.S.P. 5,898,548、U.S.P. 5,901,018などに記載されている。これらの公報では、主として超高密度記録に対応できるように技術的な改善が提案されている。しかしながら、超高密度記録に対するTMR磁気ヘッドの開発要求は、より高度なものとなり、従来にも増して高性能であるTMR磁気ヘッドの提案が待ち望まれている。

【0005】例えば、TMR素子を薄膜磁気ヘッドの読み取り素子として用いる場合、薄い絶縁層からなるトンネルバリア層を研磨面に晒す構造は、研磨加工時、もしくは研磨加工後において、電氣的ショートが発生する可能性があり好ましくない。このような問題を回避する手段として、本発明者らは先にフラックスプローブ部型のTMR構造を提案した（特願平11-188472号）。この先行技術では、強磁性トンネル効果膜を、研磨面から引っ込んだ位置に配置する共に、強磁性トンネル効果膜に直接接触させた軟磁性層の先端部を、フラックスプローブ部として、研磨面に導出してある。フラックスプローブ部は、強磁性トンネル効果膜のフリー層の一部を用いたり、強磁性トンネル効果膜とはサイズの異なる軟磁性層を新たに加えることにより形成される。

【0006】フラックスプローブ部を形成するために付与する軟磁性層にはもう一つの大切な役割がある。それは、ハードマグネットもしくは反強磁性体からの長手バイアス磁界を強磁性トンネル効果膜のフリー層に与えるバイアス磁界誘導部としての役割である。

【0007】ところが、強磁性トンネル効果膜の端部にハードマグネット等を接触させると、先に述べた幾何学的構造の故に、強磁性膜間ショートが発生し、TMR変化率を失ってしまう。

【0008】また、強磁性トンネル効果膜の上部強磁性膜、もしくは下部強磁性膜の何れかに、ハードマグネット等を直接に接触させた場合には、強磁性膜間ショートは発生しないが、ハードマグネット等を通して電流が流れてしまい、TMR変化率が劣化する。

【0009】このような問題を回避する手段として、本発明者らは、フラックスプローブ部を構成する軟磁性膜をT状の形状とし、フラックスプローブ部の基部を、トラックス幅方向に延長し、強磁性トンネル効果膜よりも幅の広い形状とし、その両端部分にハードマグネットもし

くは反強磁性層を形成する構造を提案した（特願平11-171869号）。

【0010】ところで、記録の高密度化に伴い、メディアに記録される磁気的な記録パターンは縮小し、それに伴い再生ヘッドに搭載するTMR素子の面積も縮小しなくてはならない。例えば、40 Gb/spiの記録密度に適応させるためには、TMR素子は $0.4 \times 0.4 (\mu\text{m}^2)$ 程度のサイズにまで縮小しなくてはならない。このような微細パターンの形成には、フォトリソグラフィ技術により、微細なマスクを形成し、イオンミリングにより金属膜をパターンニングするという手法がとられる。

【0011】ところが、先に提案されたように、フラックスプローブ部およびバイアス磁界誘導層を、1つの軟磁性膜で構成した場合、現在のフォトリソグラフィ技術では、パターンが微細化されるにつれて、フラックスプローブ部の角の部分が丸まってしまう。TMR素子を薄膜磁気ヘッドの読み取り素子として用いた場合、ヘッドの再生トラック幅はフラックスプローブ部の幅で決定されるので、このような角の丸まりは、トラック幅のバラツキの原因となり好ましくない。

【0012】このような問題を回避するためには、EB露光技術等を導入する必要があるが、スループットの遅さが問題であり、装置自体も高額である。

【0013】また、軟磁性層を、T状ではなく、TMR素子よりも大きな長方形とした場合には、トラック幅をTMR素子よりも小さくすることができなくなり、好ましくない。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、超高密度記録に適用できるTMR素子、薄膜磁気ヘッド、磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置を提供することにある。

【0015】本発明のもう一つの課題は、高精度の読み取りトラック幅を有するTMR素子、薄膜磁気ヘッド、磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置を提供することである。

【0016】

【課題を解決するための手段】このような課題を解決するために、本発明に係るTMR素子は、強磁性トンネル効果膜と、バイアス磁界誘導層と、フラックスガイド層とを含む。

【0017】前記強磁性トンネル効果膜は、トンネルバリア層と、フリー層と、ピン層とを含み、前記トンネルバリア層が前記フリー層と前記ピン層とによって挟まれている。

【0018】前記バイアス磁界誘導層は、前記フリー層にバイアス磁界を印加するものであって、バイアス磁界の方向で見た幅が前記強磁性トンネル効果膜の幅よりも大きくなっている。

【0019】前記フラックスガイド層は、前記バイアス磁界誘導層のバイアス磁界の方向と交差するようにして、前記バイアス磁界誘導層と積層されるとともに、前記フリー層に磁気的に結合され、一端がフラックスプローブ部を構成し、前記フラックスプローブ部はその幅が前記バイアス磁界誘導層のバイアス磁界の方向で見た幅よりも狭く、前記バイアス磁界誘導層から突出している。

【0020】本発明に係るTMR素子は、フリー層／トンネルバリア層／ピン層という多層構造からなる強磁性トンネル効果膜を有しており、トンネルバリア層を挟むフリー層とピン層との間に電流を流した場合、トンネルバリア層を流れるトンネル電流が、フリー層及びピン層の間の磁化の相対角度に依存して変化する（TMR効果）。ピン層の磁化の方向は固定であるが、フリー層の磁化の方向は、外部磁界に応じて変化する。従って、TMR素子に流れる電流またはその変化率を検出することにより、外部磁界を検出することができる。

【0021】本発明に係るTMR素子は、バイアス磁界誘導層を含む。バイアス磁界誘導層は、前記フリー層にバイアス磁界を印加する。これにより、フリー層におけるバルクハウゼンノイズを除去し、高品質の検出信号を得ることができる。バイアス磁界誘導層は、長手方向で見た幅が前記強磁性トンネル効果膜の幅よりも大きくなっている。従って、バイアス磁界誘導層の幅方向の両端部分に、強磁性トンネル効果膜から間隔を隔てて、バイアス付与手段を形成することができる。このため、バイアス付与手段による強磁性膜間ショート等を回避することができる。

【0022】更に、本発明に係るTMR素子は、フラックスガイド層を含む。フラックスガイド層は、フリー層に磁気的に結合され、一端がフラックスプローブ部を構成する。このフラックスプローブ部はバイアス磁界誘導層から突出している。外部磁界は、フラックスプローブ部から導入され、フラックスガイド層を通して、フリー層に印加される。従って、薄膜磁気ヘッドへの適用等において、フラックスプローブ部を研磨面に位置させ、強磁性トンネル効果膜は、研磨面から引っ込んだ位置に配置することができる。このため、研磨加工時、もしくは研磨加工後において、トンネルバリア層に電氣的ショートが発生するのを回避することができる。

【0023】フラックスプローブ部は、その幅が、バイアス磁界誘導層のバイアス磁界の方向で見た幅よりも狭く、バイアス磁界誘導層から突出しているから、薄膜磁気ヘッドの読み取り素子として用いた場合、ヘッドの再生トラック幅はフラックスプローブ部の幅で決定される微小値に設定できる。

【0024】しかも、フラックスガイド層は、バイアス磁界誘導層と積層されているのであって、バイアス磁界誘導層とは別の層となっているから、バイアス磁界誘導

層とは別の成膜プロセスによって、形成することができる。

【0025】フラックスガイド層は、バイアス磁界誘導層のバイアス磁界の方向と交差しており、一端がフラックスプローブ部を構成している。従って、フラックスガイド層が、端部において、丸みを生じた場合にも、その丸み部分を除去し、幅寸法の安定した部分を、フラックスプローブ部として利用することができる。このため、高精度の読み取りトラック幅を有するTMR素子を得ることができる。

【0026】具体的態様において、強磁性トンネル効果膜は、フリー層、トンネルバリア層及びピンド層の順に積層されるか、または、ピンド層、トンネルバリア層及びフリー層の順に積層される。

【0027】強磁性トンネル効果膜が、フリー層、トンネルバリア層及びピンド層の順に積層した構造を有する場合、フラックスガイド層を、バイアス磁界誘導層の上に積層し、TMR膜のフリー層をフラックスガイド層に隣接させる構造を採用することができる。この場合、フラックスガイド層は、フリー層と同体形成することができる。

【0028】強磁性トンネル効果膜が、ピンド層、トンネルバリア層及びフリー層の順に積層した構造を有する場合、バイアス磁界誘導層をフリー層に隣接させ、フラックスガイド層をバイアス磁界誘導層の上に積層する構造を採用することができる。

【0029】バイアス磁界誘導層は、バイアス付与手段を有しており、バイアス付与手段は、バイアス磁界誘導層の幅方向の両端部に接触し、かつ、ピンド層の幅方向端部との間にスペースを有する。この構造によれば、強磁性膜間ショート、及び、電流回り込みを回避できる。バイアス手段は、高保磁力材料、反強磁性材料、または反強磁性層と少なくとも一層の強磁性層との積層体から構成され得る。また、強磁性トンネル効果膜は、ピン止め層を含む。このピン止め層はピンド層の磁化をピンニングする。

【0030】本発明は、また、強磁性トンネル効果膜に電流を流すための電極構造、強磁性トンネル効果膜に対するシールド構造、更には、TMR素子を読み出し素子として用いた薄膜磁気ヘッド、この薄膜磁気ヘッドを用いた磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置についても開示する。本発明は、更に、強磁性トンネル効果膜の製造方法についても開示する。

【0031】

【発明の実施の形態】図1は本発明に係るTMR素子の一実施例を示す斜視図、図2は図1に示したTMR素子の拡大断面図、図3は図2の3-3線に沿った断面図である。これらの図は、本発明の特徴部分を容易に理解できるように、誇張して図示されている。ハッチングで示された部分の周囲は、セラミックス等なる非磁性絶縁

層によって覆われている。

【0032】図示されたTMR素子は、強磁性トンネル効果膜1と、バイアス磁界誘導層21と、フラックスガイド層22とを含む。強磁性トンネル効果膜1は、トンネルバリア層11と、フリー層12と、ピンド層13とを含む。トンネルバリア層11は、フリー層12とピンド層13とによって挟まれている。

【0033】フリー層12は、基本的に磁気情報である外部磁場に応答して自由に磁化の向きが変えられるように作用する。また、ピンド層13は、その磁化方向が、すべて一定方向を向くようにピン止めされている。そのため、通常、ピンド層13の磁化をピンニングするためのピン止め層14が、ピンド層13のトンネルバリア層11と接する側と反対の面に積層される。

【0034】バイアス磁界誘導層21は、フリー層12にバイアス磁界を印加するものであって、バイアス磁界F1の方向で見た幅が強磁性トンネル効果膜1の幅よりも大きくなっている。バイアス磁界誘導層21は、バイアス手段23、24を有する。バイアス付与手段23、24により、バイアス磁界誘導層21を介して、フリー層12のバイアス磁界が印加される。バイアス手段23、24は、高保磁力材料、反強磁性材料、または反強磁性層と少なくとも一層の強磁性層との積層体から構成され得る。

【0035】フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21のバイアス磁界の方向F1と、ほぼ直交するようにして、バイアス磁界誘導層21と積層されている。フラックスガイド層22は、更に、フリー層12に磁気的に結合され、一端がフラックスプローブ部221を構成し、フラックスプローブ部221はその幅がバイアス磁界誘導層21の幅よりも狭く、バイアス磁界誘導層21から突出している。

【0036】図示実施例において、強磁性トンネル効果膜1は、フリー層12、トンネルバリア層11及びピンド層13の順に積層されている。フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21の上に直接に積層されている。強磁性トンネル効果膜1のフリー層12は、フラックスガイド層22の一面上に、接触して設けられている。

【0037】本発明に係るTMR素子は、フリー層12／トンネルバリア層11／ピンド層13という多層構造からなる強磁性トンネル効果膜1を有しており、トンネルバリア層11を挟むフリー層12とピンド層13との間に電流を流した場合、トンネルバリア層11を流れるトンネル電流が、フリー層12及びピンド層13の間の磁化の相対角度に依存して変化する。ピンド層13の磁化の方向は固定であるが、フリー層12の磁化の方向は、外部磁界に応じて変化する。従って、TMR素子に流れる電流またはその変化率を検出することにより、外部磁界を検出することができる。

【0038】TMR素子は、バイアス磁界誘導層21を含み、バイアス磁界誘導層21により、フリー層12にバイアス磁界を印加するから、フリー層12におけるバルクハウゼンノイズを除去し、高品質の検出信号を得ることができる。バイアス磁界誘導層21は、バイアス磁界の方向F1で見た幅が強磁性トンネル効果膜1の幅よりも大きくなっているから、バイアス磁界誘導層21の幅方向の両端部分に、強磁性トンネル効果膜1から間隔Gを隔てて、バイアス付与手段23、24を形成することができる。このため、バイアス付与手段23、24によるフリー層12-ピン層13間の電氣的ショート等を回避することができる。

【0039】更に、本発明に係るTMR素子は、フラックスガイド層22を含む。フラックスガイド層22は、フリー層12に磁氣的に結合され、その一端がフラックスプローブ部221を構成する。このフラックスプローブ部221はバイアス磁界誘導層21から突出している。外部磁界は、フラックスプローブ部221から導入され、フラックスガイド層22を通して、フリー層12に印加される。従って、薄膜磁気ヘッドへの適用等において、フラックスプローブ部221を研磨面PS1（図3参照）に位置させ、強磁性トンネル効果膜1は、研磨面PS1から引っ込んだ位置に配置することができる。このため、研磨加工時、もしくは研磨加工後において、トンネルバリア層11に電氣的ショートが発生するのを回避することができる。

【0040】フラックスプローブ部221は、その幅Lfが、バイアス磁界誘導層21の幅Lmよりも狭く、バイアス磁界誘導層21から突出しているから、当該TMR素子を、薄膜磁気ヘッドの読み取り素子として用いた場合、ヘッドの再生トラック幅はフラックスプローブ部221の幅Lfで決定される微小値に設定できる。

【0041】しかも、フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21とは別の層となっているから、フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21とは別の成膜プロセスによって、形成することができる。フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21のバイアス磁界の方向F1と交差しており、一端がフラックスプローブ部221を構成している。従って、フラックスガイド層22が、その端部において、丸みを生じた場合にも、その丸み部分を除去し、幅寸法の安定した中間部分を、フラックスプローブ部221として利用することができる。このため、高精度の読み取りトラック幅を有するTMR素子を得ることができる。

【0042】強磁性トンネル効果膜1の幅Lpは、フラックスプローブ部221の幅Lfと等しいかあるいは大きく、かつ、バイアス磁界誘導層21の幅Lmよりも小さく設定されている。バイアス磁界誘導層21の幅Lmは、0.5~4 μ m程度、フラックスプローブ部221の幅Lfは、0.1~2 μ m程度とされる。

【0043】さらに、フラックスガイド層22の奥行きHは、0.01~0.3 μ m、好ましくは、0.01~0.2 μ m、さらに好ましくは、0.01~0.1 μ mに設定される。このH値は限りなく0に近い方がよいが、小さくなるにつれ、静電破壊の危険性が生じたり、あるいは研磨工程における、フリー層12とピン層13との電氣的ショートの危険性が生じる。従って、下限値は、0.01 μ m程度とするのがよい。一方、このH値が、0.3 μ mを超えると、出力が低下したり、幅方向のバイアス磁界が不十分となりバルクハウゼンノイズが生じたりしてしまう。

【0044】強磁性トンネル効果膜1の積層方向の上下には、一対の電極25、26が対向配置されている。この一対の電極25、26により強磁性トンネル効果膜1にセンス電流が供給される。さらにこれらをそれぞれ覆うように一対の磁気シールド層27、28が対向配置される。

【0045】バイアス磁界誘導層21は、バイアス付与手段23、24によって、幅方向にバイアス磁界が印加されるようになっている。バイアス磁界誘導層21の幅Lmは、ピン層13の幅Lpよりも大きく設定されており、バイアス磁界誘導層21は、その幅Lmがピン層13の長さLpよりも長い分だけ、その両端部に、拡張部位をそれぞれ備えた形態となっている。

【0046】間隔Gは、TMR変化率を実質的に低下させないようにするために所定範囲に定めることが望ましい。好ましい態様として実験的に見出された数値を挙げると、間隔Gは、0.02 μ m以上、特に、0.02 μ m以上0.3 μ m以下の範囲、さらには0.02 μ m以上0.15 μ m未満の範囲とすることが好ましい。

【0047】間隔Gの値が、0.02 μ m未満となると、TMR変化率が低下する傾向にある。この一方で、このG値が大きくなり過ぎて、0.3 μ mを超えると、有効トラック幅が広がってしまい高記録密度化への将来の要求に合致しなくなる傾向が生じる。

【0048】また、本発明におけるフリー層12の厚さは、特に限定されないが、2~5nm、好ましくは、4~3nm、より好ましくは6~2nmの範囲に設定するのがよい。この厚さが、2nm未満となると、バイアス磁界誘導層21の幅方向の幅Lmを十分な大きさとするのが成膜技術上、困難になる。また、この厚さが50nmを超えると、フリー層12内部の特性のばらつきにより、電子スピン分極率の分散が生じ、結果的にTMR変化率が減少してしまうという不都合が生じる。

【0049】フリー層12やピン層13を構成する材質は、高いTMR変化率が得られるように高スピン分極材料が好ましく、例えば、Fe、Co、Ni、FeCo、NiFe、CoZrNb、FeCoNi等が用いられる。これらは2層以上の積層体であってもよい。フリー層12の膜厚は、前述したように2~5nm、好ましくは6~2nmとされる。膜厚が厚く

なりすぎると、出力が低下する傾向があり、また、膜厚が薄くなりすぎると、磁気特性が不安定となりヘッド動作時のノイズが増大するという不都合が生じる。ピンド層13の膜厚は、1～10 nm、好ましくは2～5 nmとされる。膜厚が厚くなりすぎると、ピン止め層14による磁化のピンニングが弱まり、また、膜厚が薄くなりすぎると、TMR変化率が減少する傾向が生じる。

【0050】ピンド層13の磁化をピン止めするピン止め層14は、そのピン止め機能を果たすものであれば、特に限定されないが、通常、反強磁性材料が用いられる。厚さは、通常、60～5 nm程度とされる。

【0051】トンネルバリア層11は、 Al_2O_3 、 NiO 、 GdO 、 MgO 、 Ta_2O_5 、 MoO_2 、 TiO_2 、 WO_2 等から構成される。トンネルバリア層11の厚さは、素子の低抵抗化のためできるだけ薄いことが望ましいが、あまり薄すぎてピンホールが生じるとリーク電流がながれてしまい好ましくない。一般には、0.5～2 nm程度とされる。

【0052】本発明において、フリー層12を、例えば、 NiFe 層（厚さ2 nm）/ Ru 層（厚さ0.7 nm）/ NiFe 層（厚さ2.5 nm）の3層積層体で例示される合成フェリ磁石（synthetic ferrimagnet）とすることも好ましい態様の一つである。この場合には、上下の NiFe 層および NiFe 層の磁化方向はそれぞれ、互いに逆方向となっている。合成フェリ磁石を用いた場合、実効的なフリー層12の厚さを薄く設定することができるため、磁場感度が向上し、出力が大きくなるというメリットがある。また、このような合成フェリ磁石は、ピンド層13にも適用できる。

【0053】また、上記の実施の形態において、バイアス付与手段23、24は、フリー層12の両端部の上側に配置されているが、これに限定されことなく下側に配置してもよい。

【0054】図4は本発明に係るTMR素子の別の実施例を示す斜視図、図5は図4に示したTMR素子の拡大断面図、図6は図5の6-6線に沿った断面図である。図において、図1～3に現れた構成部分と同一の構成部分については、同一の参照符号を付してある。この実施例では、強磁性トンネル効果膜1は、フリー層12、トンネルバリア層11及びピンド層13の順に積層されている。フラックスガイド層22は、フリー層12と同様に形成されている。フラックスガイド層22は、フリー層12と同体であるが、バイアス磁界誘導層21とは別層であり、バイアス磁界誘導層21の上に積層されている。

【0055】図7は本発明に係るTMR素子の別の実施例を示す斜視図、図8は図7の8-8線に沿った断面図である。図において、図1～3に現れた構成部分と同一の構成部分については、同一の参照符号を付してある。この実施例では、強磁性トンネル効果膜1は、ピンド層13、トンネルバリア層11及びフリー層12の順に積

層した構造を有する。バイアス磁界誘導層21はフリー層12に隣接し、フラックスガイド層22はバイアス磁界誘導層21の上に積層されている。フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21とは別層である。

【0056】図9は本発明に係るTMR素子の別の実施例を示す斜視図、図10は図9の10-10線に沿った断面図である。図において、図1～3に現れた構成部分と同一の構成部分については、同一の参照符号を付してある。この実施例では、強磁性トンネル効果膜1は、ピンド層13、トンネルバリア層11及びフリー層12の順に積層した構造を有する。バイアス磁界誘導層21は、フリー層12と同様に形成されている。フラックスガイド層22は、バイアス磁界誘導層21とは別層であり、バイアス磁界誘導層21の上に積層されている。

【0057】次に、図11～23を参照し、図1～3に図示したTMR素子の製造方法について、特に、バイアス磁界誘導層21及びフラックスガイド層22の製造工程を説明する。製造に際しては、フォトリソ法、イオンミリング、リフトオフ、スパッタ成膜法等の公知の種々の薄膜パターン形成技術が用いられるが、ここでは個別的な詳細手法の説明は省略する。

【0058】まず、図11、12に図示するように、シールド層27の上に積層した電極層25の上に、バイアス磁界誘導層21を成膜する。シールド層27及び電極層25はセラミックス等の非磁性絶縁層によって覆われている。

【0059】次に、図13、14に図示するように、バイアス磁界誘導層21の上にフラックスガイド層22を成膜する。上述したように、例えば、40 Gb/sの記録密度に適応させるためには、強磁性トンネル効果膜は $0.4 \times 0.4 (\mu\text{m}^2)$ 程度のサイズにまで縮小しなくてはならない。フラックスガイド層22も、上述したサイズに対応した微細パターンになる。このような微細パターンを、フォトリソグラフィ技術で形成すると、図13に図示するように、フラックスガイド層22の角部に丸みを生じる。

【0060】次に、図15に示すように、バイアス磁界誘導層21及びフラックスガイド層22の上に、フリー層となる強磁性層12、トンネルバリア層となる絶縁層11及びピンド層となる強磁性層13を成膜する。これらの各層11～14の成膜に当たっては、各層11～14の成膜前に、成膜する表面をイオンエッチングによりクリーニングすることが好ましい。このようなクリーニングによれば、各層の界面にレジスト残存汚染層または酸化層が形成されるのを回避し、最終的に得られる強磁性トンネル効果膜の抵抗値増大を防ぐことができる。

【0061】次に、図16に示すように、強磁性層13の表面にレジスト膜100を、所定のパターンで形成する。レジスト膜100は、バイアス磁界誘導層21とフラックスガイド層22とが重なる領域から、フラックス

ガイド層22の先端領域に伸びるパターンを有する。

【0062】そして、図17に示すように、レジスト膜100によって覆われていない部分を、イオンミリング等によって除去する。図18、19は、除去後のパターンを示している。図18、19に示すように、フラックスガイド層22の上に、強磁性層12、絶縁層11及び強磁性層13の積層膜が形成される。この積層膜のパターンは、レジスト膜100とほぼ同じパターンとなる。

【0063】次に、レジスト膜100を周知の手段に従って、剥離した後、図20に示すように、別のレジスト膜110を、所定のパターンで形成する。レジスト膜110は、例えば、バイアス磁界誘導層21の両端の丸みを帯びた先端部、及び、フラックスプローブ膜22の丸みを帯びた先端部が露出するパターンとなるように形成する。そして、図21に示すように、イオンミリング等の手段によって、レジスト膜110によって覆われていないバイアス磁界誘導層21の両端の丸みを帯びた先端部、及び、フラックスプローブ膜22の丸みを帯びた先端部を除去する。

【0064】図22、23は上述したミリングの後、レジスト膜110を除去した後の状態を示す。図示するように、バイアス磁界誘導層21は、両端の丸みを帯びた先端部が除去され、安定した幅で所定の長さを有するようにパターンニングされる。また、フラックスガイド層22の丸みを帯びた両端部も除去され、フラックスガイド層22及びその上の強磁性トンネル効果膜の幅も安定した寸法になる。

【0065】次に、図24に示すように、強磁性トンネル効果膜1の表面が、一部露出するようにして、レジスト膜120を形成し、図25に示すように、イオンミリングを行う。このイオンミリングにおいて、強磁性トンネル効果膜1を構成する強磁性層13、トンネルバリア層11及び強磁性層12をミリングする。これにより、図26、27に示すように、所定の寸法で突出するフラックスプローブ端221を有するフラックスガイド層22が得られる。図4～6に図示したTMR素子も、同様のプロセスに従って製造できる。

【0066】次に、図28～35を参照して、図7、8に図示したTMR素子の製造方法について説明する。まず、図28、29に図示するように、シールド層27の上に積層した電極層25の上に、フリー層となる強磁性層12、トンネルバリア層となる絶縁層11及びピン層となる強磁性層13を成膜した後、バイアス磁界誘導層21を成膜する。シールド層27、電極層25、強磁性層12、絶縁層11及び強磁性層13の周囲は、セラミックス等の非磁性絶縁層によって覆われている。前に述べたように、強磁性トンネル効果膜1を構成する各層11～14の成膜に当たっては、各層11～14の成膜前に、成膜する表面をイオンエッチングによりクリーニングすることが好ましい。このようなクリーニングによ

れば、各層の界面にレジスト残存汚染層または酸化層が形成されるのを回避し、最終的に得られる強磁性トンネル効果膜の抵抗値増大を防ぐことができる。

【0067】次、図30、31に図示するように、バイアス磁界誘導層21の上にフラックスガイド層22を成膜する。上述したように、例えば、40Gbspiの記録密度に適応させるためには、強磁性トンネル効果膜は $0.4 \times 0.4 (\mu m^2)$ 程度のサイズにまで縮小しなくてはならない。フラックスガイド層22も、上述したサイズに対応した微細パターンになる。このような微細パターンを、フォトリソグラフィ技術で形成すると、図30に図示するように、フラックスガイド層22の角部に丸みを生じる。

【0068】次に、図32に示すように、レジスト膜130を、所定のパターンで形成する。レジスト膜130は、例えば、バイアス磁界誘導層21の両端の丸みを帯びた先端部、及び、フラックスプローブ膜22の丸みを帯びた先端部が露出するパターンとなるように形成する。そして、図33に示すように、イオンミリング等の手段によって、レジスト膜130によって覆われていないバイアス磁界誘導層21の両端部、及び、フラックスプローブ膜22の丸みを帯びた先端部を除去する。これにより、幅の安定したバイアス磁界誘導層21及びフラックスガイド層22が得られる。

【0069】図34～36は上述したミリングの後、レジスト膜130を除去して得られた形状を示す。図示するように、バイアス磁界誘導層21は、両端の丸みを帯びた先端部が除去され、安定した幅で所定の長さを有するようにパターンニングされる。また、フラックスガイド層22の丸みを帯びた両端部も除去され、フラックスガイド層22及びその上の強磁性トンネル効果膜の幅も安定した寸法になる。これにより、所定の寸法で突出するフラックスプローブ端221を有するフラックスガイド層22が得られる。図9、10に図示したTMR素子も、同様のプロセスに従って製造できる。

【0070】図37は上述したTMR素子を読み出し素子として用い、誘導型電磁変換素子を書き込み素子として用いた面内記録用薄膜磁気ヘッドの斜視図、図38は図37に示した薄膜磁気ヘッドの拡大断面図を示している。図示の薄膜磁気ヘッドは、スライダ4の上に本発明に係るTMR素子で構成された読み出し素子6及び誘導型磁気変換素子でなる書き込み素子5を有する。矢印A1は媒体走行方向を示す。図において、寸法は部分的に誇張されており、実際の寸法とは異なる。

【0071】スライダ4は、媒体対向面側にレール41、42を有し、レールの表面がABS43、44として利用される。レール41、42は2本に限らない。1～3本のレールを有することがあり、レールを持たない平面となることもある。また、浮上特性改善等のために、媒体対向面に種々の幾何学的形状が付されることも

ある。何れのタイプのスライダ4であっても、本発明の適用が可能である。また、スライダ4は、レールの表面に、例えば8～10nm程度の膜厚を有するDLC等の保護膜を備えることもあり、このような場合は保護膜の表面がABS43、44となる。スライダ4は Al_2O_3 -TiC等である基体410の表面に Al_2O_3 、 SiO_2 等の無機絶縁膜420を設けたセラミック構造体である。

【0072】書き込み素子5及び読み取り素子6は、レール41、42の一方または両者のトレーリング、エッジTRの側に備えられている。書き込み素子5及び読み取り素子6は、スライダ4に備えられ、電磁変換のための端部がABS43、44と近接した位置にある。トレーリング、エッジTRの側にあるスライダ側面には、書き込み素子5に接続された取り出し電極45、46及び読み取り素子6に接続された取り出し電極47、48がそれぞれ設けられている。

【0073】書き込み素子5は、読み取り素子6に対する第2のシールド膜を兼ねている第1の磁性膜51、第2の磁性膜52、コイル膜53、アルミナ等であるギャップ膜54、絶縁膜55及び保護膜56などを有している。第2のシールド膜は、第1の磁性膜51から独立して備えられていてもよい。

【0074】第1の磁性膜51及び第2の磁性膜52の一端部（先端部）510、520は微小厚みのギャップ膜54を隔てて対向するポール部となっており、ポール部において書き込みを行なう。第1及び第2の磁性膜51、52は、単層であってもよいし、複層膜構造であってもよい。第1及び第2の磁性膜51、52の複層膜化は、例えば、特性改善を目的として行われることがある。ポール部の構造に関しても、トラック幅の狭小化、記録能力の向上等の観点から、種々の改良、及び、提案がなされている。本発明においては、これまで提案された何れのポール構造も採用できる。ギャップ膜54は非磁性金属膜またはアルミナ等の無機絶縁膜によって構成される。

【0075】第2の磁性膜52は、ポール部の側において、ギャップ膜54の面と平行な面に対して、ある角度で傾斜して立ち上がる。第2の磁性膜52は、更に、第1の磁性膜51との間にインナーギャップを保って、ABS43、44の後方に延び、後方において第2の磁性膜52に結合されている。これにより、第1の磁性膜51、第2の磁性膜52及びギャップ膜54を巡る薄膜磁気回路が完結する。

【0076】コイル膜53は、第1及び第2の磁性膜51、52の間に挟まれ、後方結合部の周りを渦巻き状に回る。コイル膜53の両端は、取り出し電極45、46に導通されている（図37参照）。コイル膜53の巻数および層数は任意である。コイル膜53は絶縁膜55の内部に埋設されている。

【0077】絶縁膜55は第1及び第2の磁性膜51、

52の間のインナーギャップの内部に充填されている。絶縁膜55の表面には第2の磁性膜52が備えられている。絶縁膜55は、有機絶縁樹脂膜またはセラミック膜で構成する。セラミック膜の代表例は、 Al_2O_3 膜または SiO_2 膜である。絶縁膜55をセラミック膜によって構成すると、有機絶縁膜を用いた場合に比較して、絶縁膜55の熱膨張が小さくなるので、最大突出量を低減するのによい結果が得られる。

【0078】保護膜56は、保護膜56は書き込み素子5の全体を覆っている。これにより、書き込み素子5の全体が、保護膜56によって保護されることになる。保護膜56は Al_2O_3 または SiO_2 等の無機絶縁材料で構成されている。

【0079】読み取り素子6は、本発明に係るTMR素子で構成されている。この読み取り素子6は、第1のシールド膜61と、第2のシールド膜63との間において、絶縁膜63の内部に配置されている。絶縁膜63はアルミナ等によって構成されている。読み取り素子6は第1のシールド膜61及び第2のシールド膜62に導通する取り出し電極47、48に接続されている（図37参照）。

【0080】図39は垂直記録用薄膜磁気ヘッドの拡大断面図である。図示された垂直記録用薄膜磁気ヘッドにおいて、第2の磁性膜52は、主磁極525と、補助磁極526とを含んでいる。主磁極525は垂直書き込みポール部を構成し、補助磁極526は主磁極525及び第1の磁性膜51を磁氣的に結合する。第1の磁性膜51は主磁極525から生じた磁束の戻り磁路を構成する。コイル膜53は主磁極525及び補助磁極526の周りに巻かれている。他の構造は、図37に示した面内記録用薄膜磁気ヘッドと実質的に同じであるので、説明は省略する。垂直記録用薄膜磁気ヘッドを用いた磁気記録の特徴は、磁気ディスクの磁気記録膜を、膜面と垂直となる方向に磁化して磁気記録を行うので、極めて高い記録密度を実現できることである。

【0081】図40は本発明に係る磁気ヘッド装置の一部を示す正面図、図41は図40に示した磁気ヘッド装置の底面図である。磁気ヘッド装置は、薄膜磁気ヘッド8と、ヘッド支持装置7とを含んでいる。薄膜磁気ヘッド8は図37～39を参照して説明した本発明に係る薄膜磁気ヘッドである。

【0082】ヘッド支持装置7は、金属薄板でなる支持体73の長手方向の一端にある自由端に、同じく金属薄板でなる可撓体71を取付け、この可撓体71の下面に薄膜磁気ヘッド8を取付けた構造となっている。

【0083】可撓体71は、支持体73の長手方向軸線と略平行して伸びる2つの外側枠部75、76と、支持体73から離れた端において外側枠部75、76を連結する横枠74と、横枠74の略中央部から外側枠部75、76に略平行するように延びていて先端を自由端と

した舌状片72とを有する。

【0084】舌状片72のほぼ中央部には、支持体73から隆起した、例えば半球状の荷重用突起77が設けられている。この荷重用突起77により、支持体73の自由端から舌状片72へ荷重力が伝えられる。

【0085】舌状片72の下面に薄膜磁気ヘッド8を接着等の手段によって取付けてある。薄膜磁気ヘッド8は、空気流出側端側が横枠74の方向になるように、舌状片72に取付けられている。本発明に適用可能なヘッド支持装置7は、上記実施例に限らない。

【0086】図42は本発明に係る磁気ディスク装置の構成を模式的に示す図である。図示された磁気ディスク装置は、磁気ヘッド装置9と、磁気ディスク10とを含む。磁気ヘッド装置9は図40、41に図示したものである。磁気ヘッド装置9は、ヘッド支持装置7の一端が位置決め装置11によって支持され、かつ、駆動される。磁気ヘッド装置の薄膜磁気ヘッド8は、ヘッド支持装置7によって支持され、磁気ディスク10の磁気記録面と対向するように配置される。

【0087】磁気ディスク10が、図示しない駆動装置により、矢印A1の方向に回転駆動されると、薄膜磁気ヘッド8が、微小浮上量で、磁気ディスク10の面から浮上する。図42に図示された磁気ディスク装置はロータリー、アクチュエータ方式と称される駆動方式であり、ヘッド支持装置7の先端部に取り付けられた薄膜磁気ヘッド8は、ヘッド支持装置7を回転駆動する位置決め装置11により、磁気ディスク10の径方向b1またはb2に駆動され、磁気ディスク10上の所定のトラック位置に位置決めされる。そして、所定のトラック上で、書き込み素子5による磁気記録、及び、TMR素子を有する読み取り素子6による読み取り動作が行われる。

【0088】以上、好ましい実施例を参照して本発明の内容を具体的に説明したが、本発明の基本的技術思想及び教示に基づいて、当業者であれば、種々の変形態様を採り得ることは自明である。

【0089】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、次のような効果を得ることができる。

(a) 超高密度記録に適用できるTMR素子、薄膜磁気ヘッド、磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置を提供することができる。

(b) 高精度の読み取りトラック幅を有するTMR素子、薄膜磁気ヘッド、磁気ヘッド装置及び磁気ディスク装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るTMR素子の一実施例を示す斜視図である。

【図2】図1に示したTMR素子の拡大断面図である。

【図3】図2の3-3線に沿った断面図である。

【図4】本発明に係るTMR素子の別の実施例を示す斜視図である。

【図5】図4に示したTMR素子の拡大断面図である。

【図6】図5の6-6線に沿った断面図である。

【図7】本発明に係るTMR素子の別の実施例を示す斜視図である。

【図8】図7の8-8線に沿った断面図である。

【図9】本発明に係るTMR素子の別の実施例を示す斜視図である。

【図10】図9の10-10線に沿った断面図である。

【図11】図1-3に図示したTMR素子の製造方法に含まれる工程を示す図である。

【図12】図11の12-12線に沿った断面図である。

【図13】図11、12に示した工程の後の工程を示す図である。

【図14】図13の14-14線に沿った断面図である。

【図15】図13、14に示した工程の後の工程を示す断面図である。

【図16】図15に示した工程の後の工程を示す図である。

【図17】図16の17-17線に沿った断面図である。

【図18】図16、17に示した工程の後の工程を示す図である。

【図19】図18の19-19線に沿った断面図である。

【図20】図18、19に示した工程の後の工程を示す図である。

【図21】図20の21-21線に沿った断面図である。

【図22】図20、21に示した工程の後の工程を示す図である。

【図23】図22の23-23線に沿った断面図である。

【図24】図22、23に示した工程の後の工程を示す図である。

【図25】図24の25-25線に沿った断面図である。

【図26】図24、25に示した工程の後の工程を示す図である。

【図27】図26の27-27線に沿った断面図である。

【図28】図7、8に図示したTMR素子の製造方法に含まれる工程を示す図である。

【図29】図28の29-29線に沿った断面図である。

【図30】図28、29の工程の後の工程を示す図である。

【図31】図30の31-31線に沿った断面図である。

【図32】図30、31に示した工程の後の工程を示す図である。

【図33】図32の33-33線に沿った断面図である。

【図34】図32、33の工程を経て得られたパターンを示す図である。

【図35】図34の35-35線に沿った断面図である。

【図36】図34の36-36線に沿った断面図である。

【図37】本発明に係るTMR素子を読み出し素子として用い、誘導型電磁変換素子を書き込み素子として用いた面内記録用薄膜磁気ヘッドの斜視図ある。

【図38】図37に示した薄膜磁気ヘッドの拡大断面図である。

【図39】本発明に係るTMR素子を読み出し素子として用いた垂直記録用薄膜磁気ヘッドの拡大断面図である。

【図40】本発明に係る磁気ヘッド装置の一部を示す正面図である。

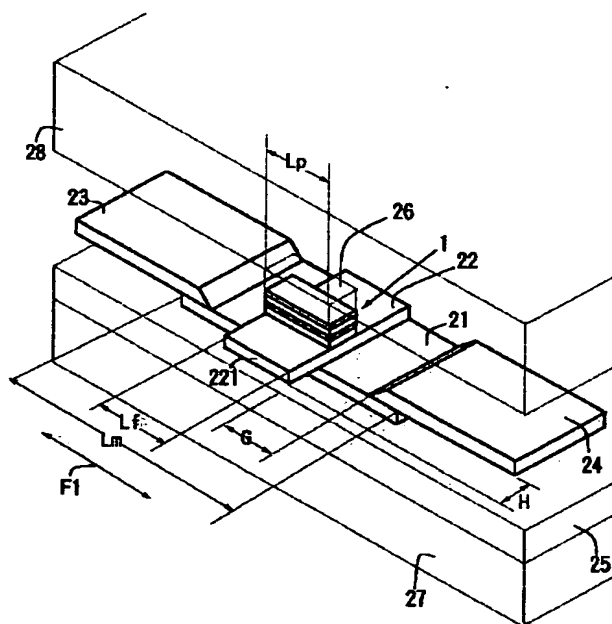
【図41】本発明に係る磁気ヘッド装置の一部を示す正面図である。

【図42】本発明に係る磁気ディスク装置の構成を模式的に示す図である。

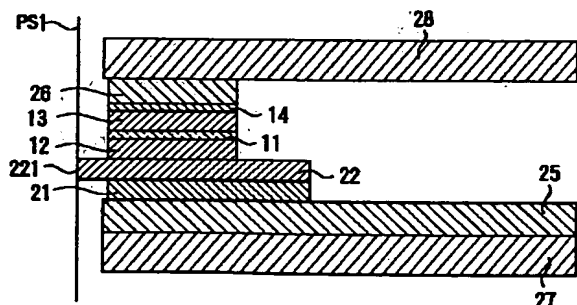
【符号の説明】

- | | |
|-----|------------|
| 1 | 強磁性トンネル効果膜 |
| 11 | トンネルバリア層 |
| 12 | フリー層 |
| 13 | ピンド層 |
| 21 | バイアス磁界誘導層 |
| 22 | フラックスガイド層 |
| 221 | フラックスプローブ部 |

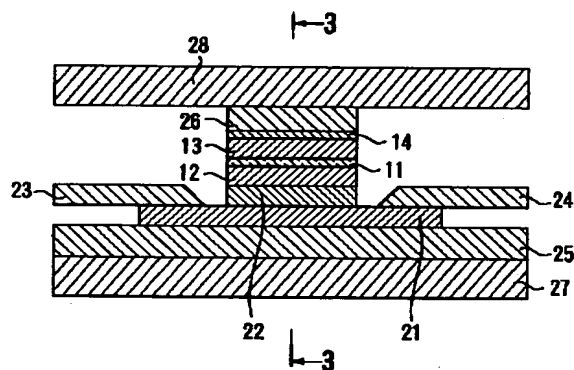
【図1】



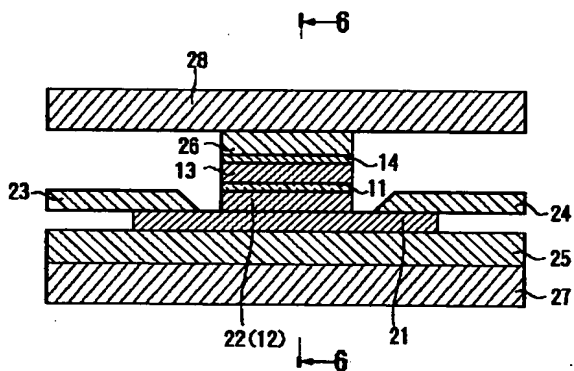
【図3】



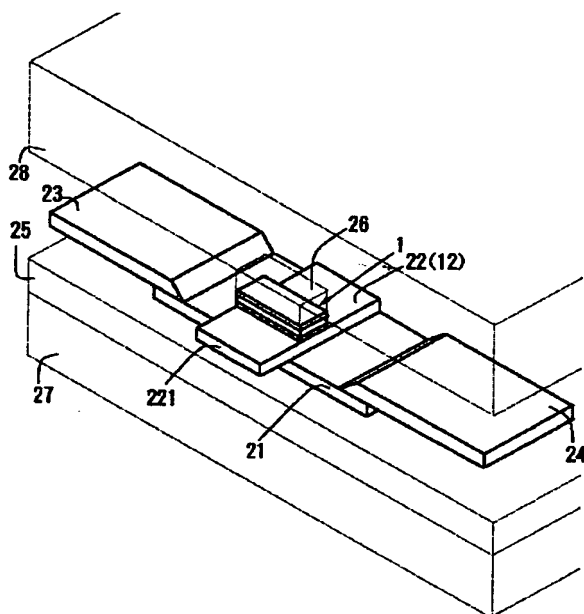
【図2】



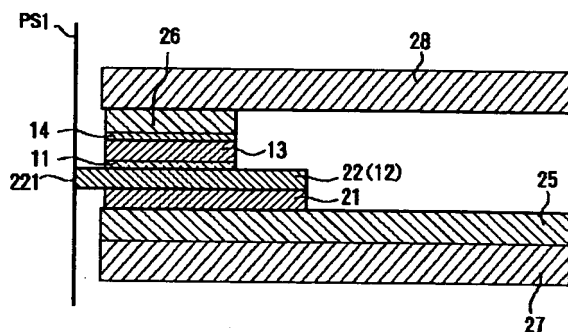
【図5】



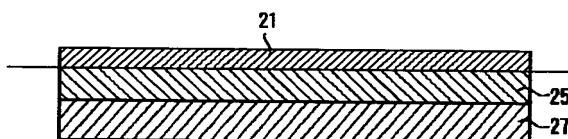
【図 4】



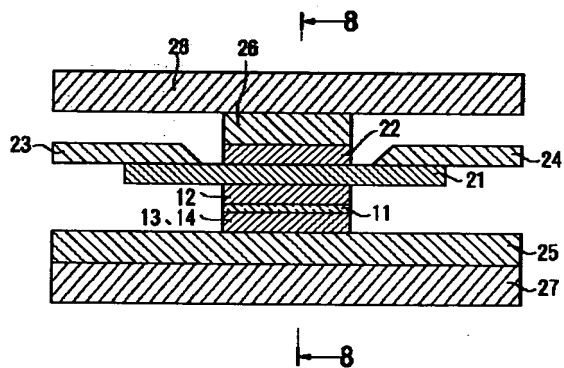
【図 6】



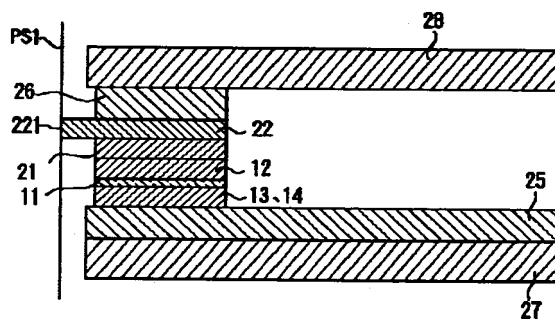
【図 1 2】



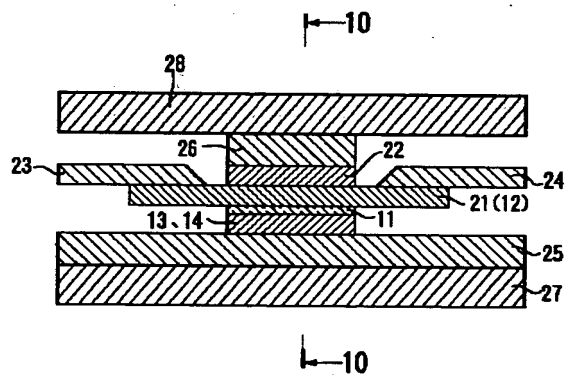
【図 7】



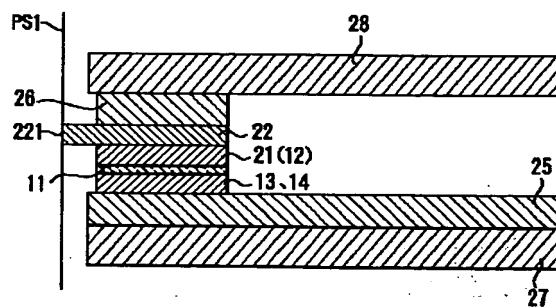
【図 8】



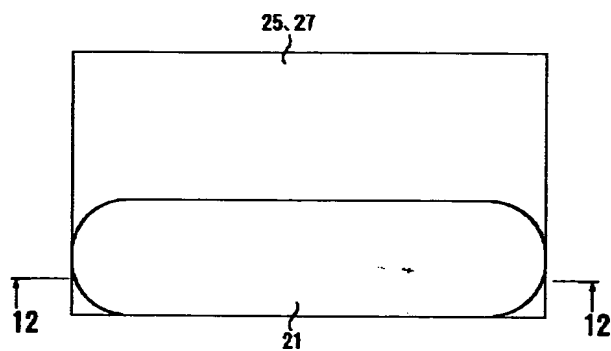
【図 9】



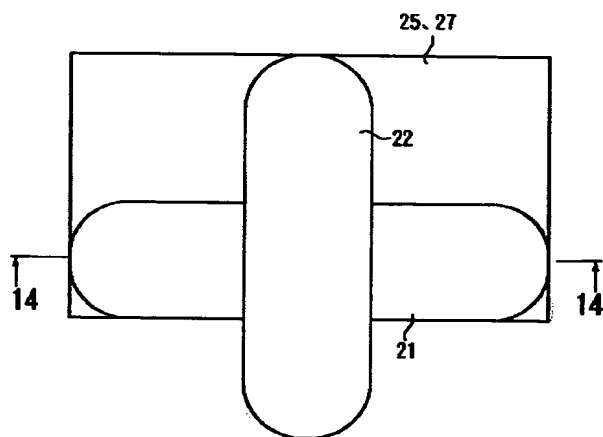
【図 1 0】



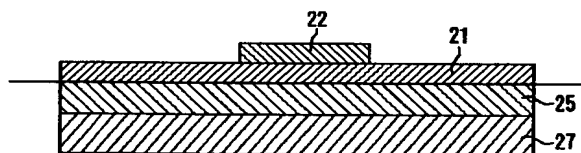
【図11】



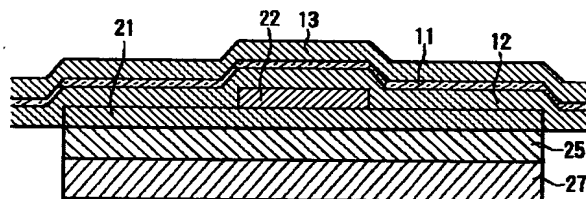
【図13】



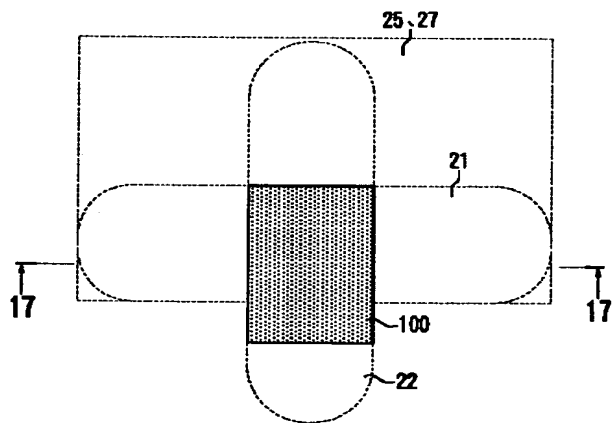
【図14】



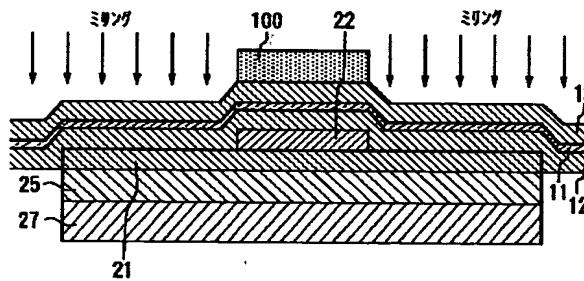
【図15】



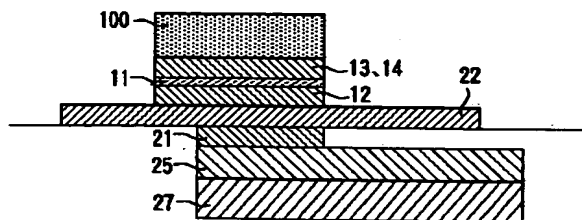
【図16】



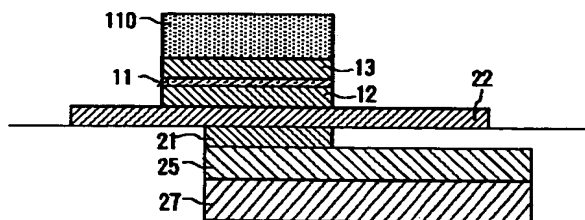
【図17】



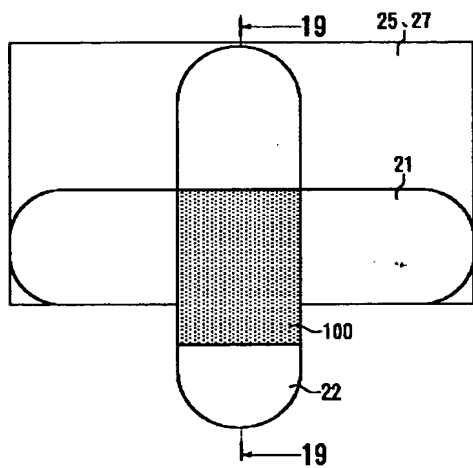
【図19】



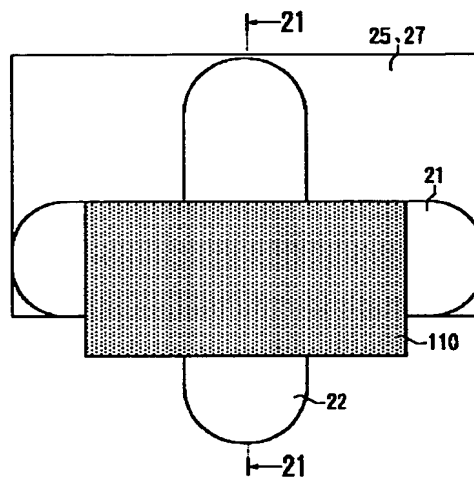
【図21】



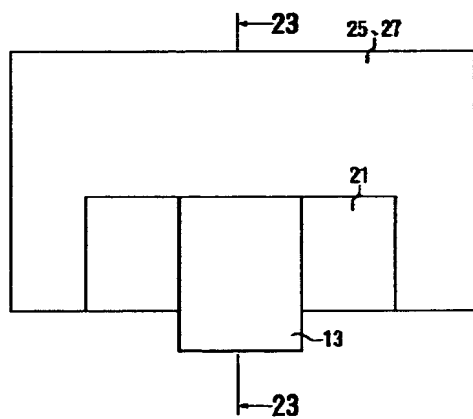
【図18】



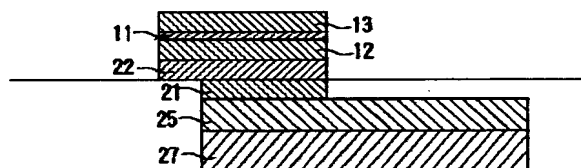
【図20】



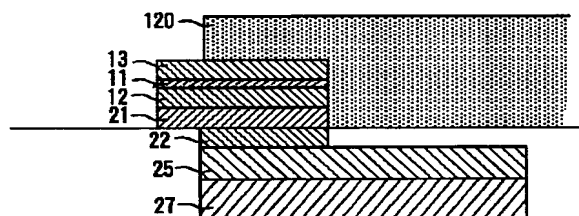
【図22】



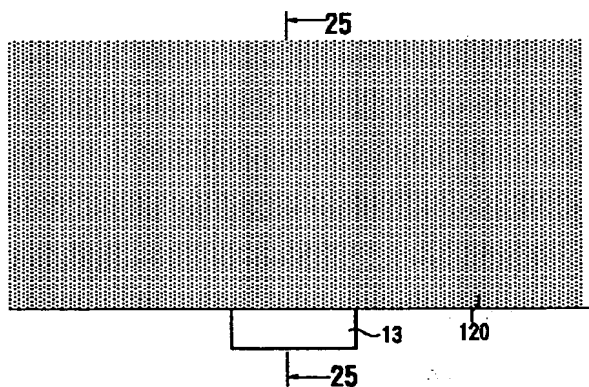
【図23】



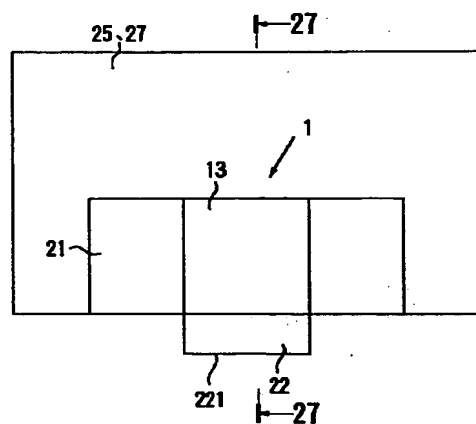
【図25】



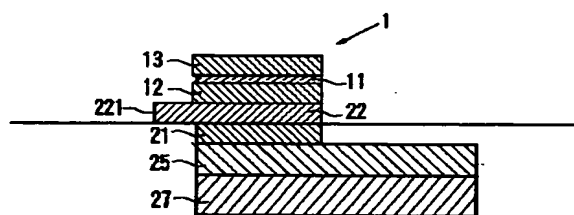
【図24】



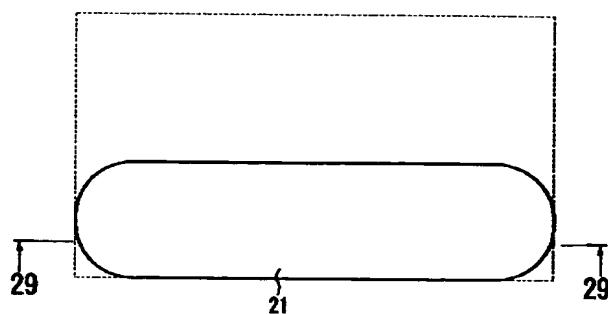
【図26】



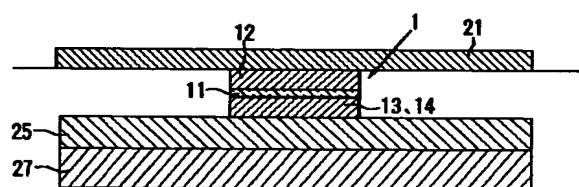
【図27】



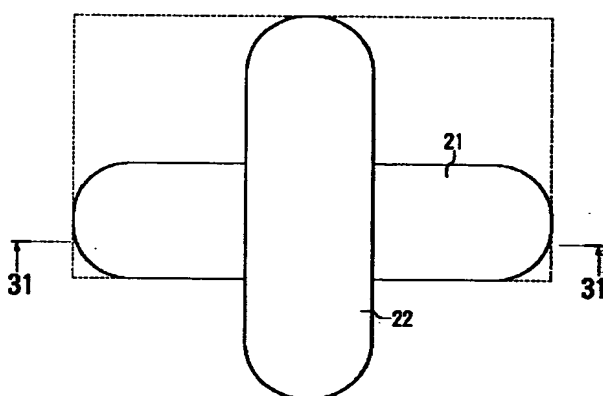
【図28】



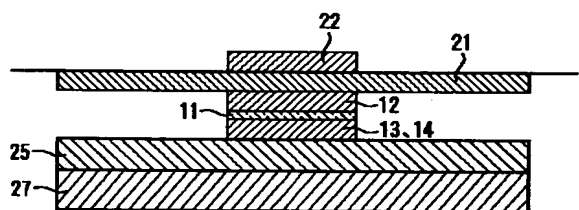
【図29】



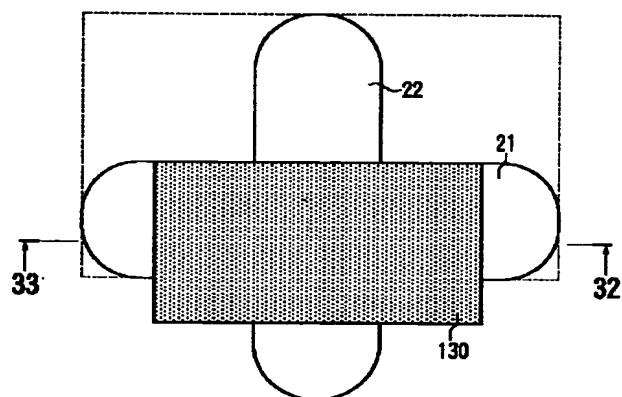
【図30】



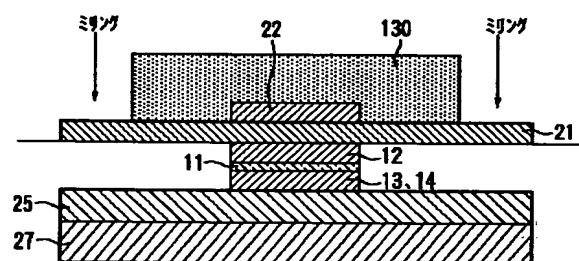
【図31】



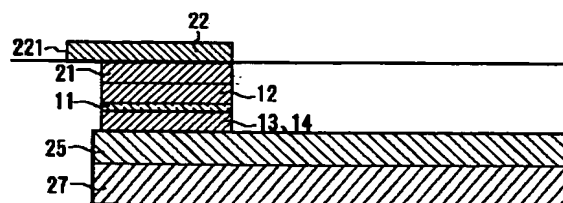
【図32】



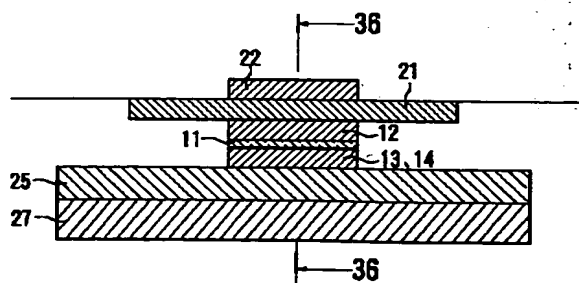
【図33】



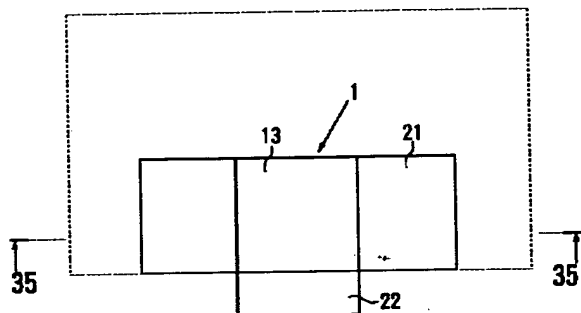
【図36】



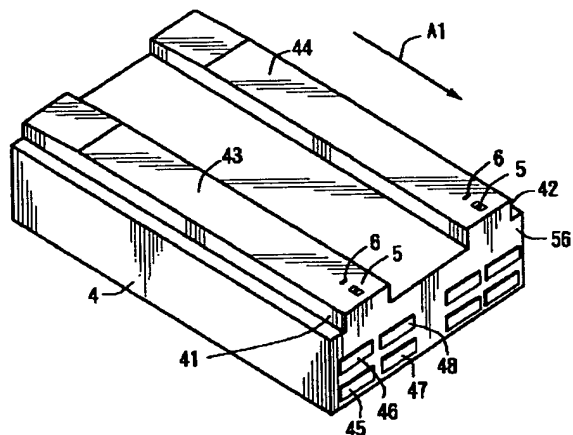
【図35】



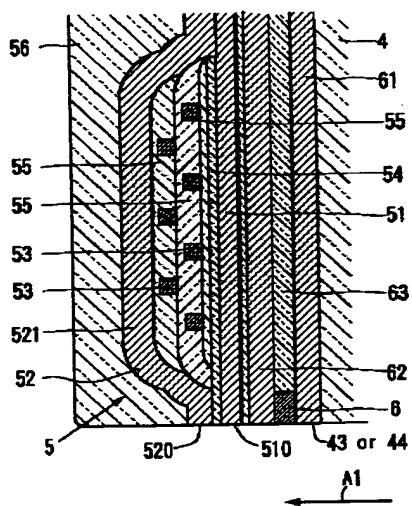
【図34】



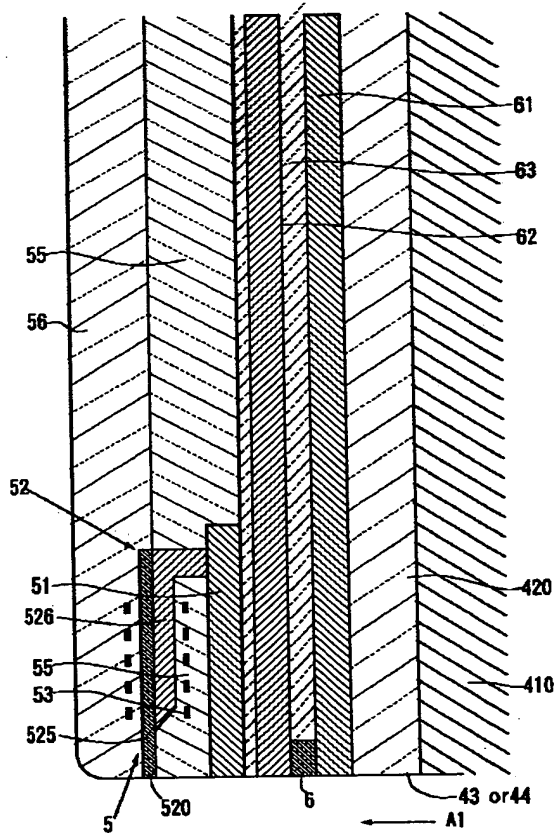
【図37】



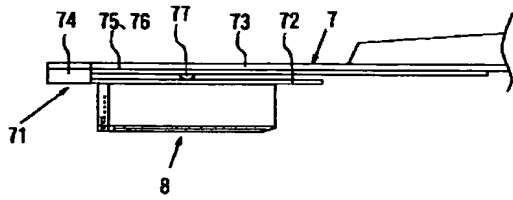
【図38】



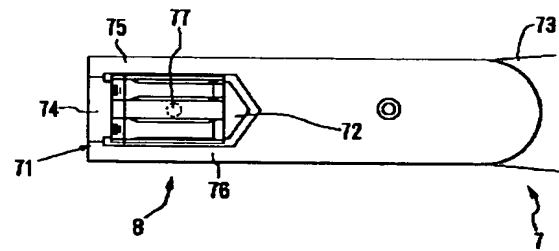
【図39】



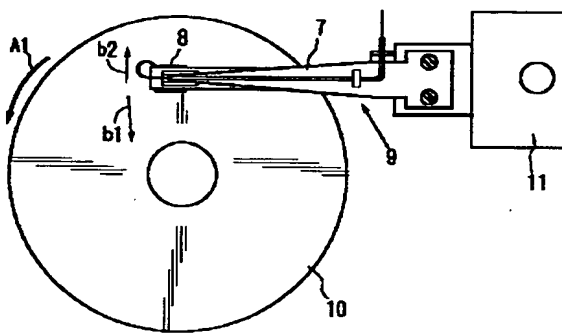
【図40】



【図41】



【図42】



フロントページの続き

(72) 発明者 荒木 悟
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケー株式会社内

Fターム(参考) 5D034 BA04 BA05 BA15 BB09 BB12
CA04 CA08 DA07

THIS PAGE BLANK (USPTO)